

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60122-1

QC 680000

Troisième édition
Third edition
2002-08

**Résonateurs à quartz sous assurance
de la qualité –**

**Partie 1:
Spécification générique**

Quartz crystal units of assessed quality –

**Part 1:
Generic specification**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60122-1:2002

Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- Site web de la CEI (www.iec.ch)
- Catalogue des publications de la CEI

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI (www.iec.ch/catlg-f.htm) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

- IEC Just Published

Ce résumé des dernières publications parues (www.iec.ch/JP.htm) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

- Service clients

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- IEC Web Site (www.iec.ch)
- Catalogue of IEC publications

The on-line catalogue on the IEC web site (www.iec.ch/catlg-e.htm) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

- IEC Just Published

This summary of recently issued publications (www.iec.ch/JP.htm) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

- Customer Service Centre

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60122-1

QC 680000

Troisième édition
Third edition
2002-08

**Résonateurs à quartz sous assurance
de la qualité –**

**Partie 1:
Spécification générique**

Quartz crystal units of assessed quality –

**Part 1:
Generic specification**

© IEC 2002 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

W

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	8
1 Généralités	12
1.1 Domaine d'application	12
1.2 Références normatives	12
1.3 Ordre de priorité	16
2 Terminologie et prescriptions générales	16
2.1 Généralités	16
2.2 Termes, définitions et classification des phénomènes	16
2.3 Valeurs et caractéristiques préférentielles	46
2.3.1 Gammes de températures en degrés Celsius (°C) pour un fonctionnement à température ambiante	46
2.3.2 Gammes de températures élevées en degrés Celsius (°C) convenant pour un fonctionnement en enceinte	46
2.3.3 Tolérance de fréquence (1×10^{-6})	46
2.3.4 Conditions de fonctionnement	46
2.3.5 Niveaux d'excitation	46
2.3.6 Influence du niveau d'excitation	48
2.3.7 Catégorie climatique	48
2.3.8 Sévérité des secousses	48
2.3.9 Sévérité des vibrations	50
2.3.10 Sévérité des chocs	50
2.3.11 Taux de fuite	50
2.4 Marquage	50
3 Procédures d'assurance de la qualité	52
3.1 Etape initiale de fabrication	52
3.2 Modèles associables	52
3.3 Sous-traitance	52
3.4 Agrément du fabricant	52
3.5 Procédures d'agrément	52
3.5.1 Généralités	52
3.5.2 Agrément de savoir-faire	52
3.5.3 Homologation	54
3.6 Procédures pour l'agrément de savoir-faire	54
3.6.1 Généralités	54
3.6.2 Aptitude à l'agrément de savoir-faire	54
3.6.3 Demande d'agrément de savoir-faire	54
3.6.4 Obtention de l'agrément de savoir-faire	54
3.6.5 Manuel de savoir-faire	54
3.7 Procédures pour l'homologation	54
3.7.1 Généralités	54
3.7.2 Aptitude à l'agrément du fabricant	54
3.7.3 Demande d'homologation	56
3.7.4 Obtention de l'homologation	56
3.7.5 Contrôle de conformité de la qualité	56
3.8 Méthodes d'essai	56
3.9 Exigences de sélection	56

CONTENTS

FOREWORD	9
1 General	13
1.1 Scope	13
1.2 Normative references	13
1.3 Order of precedence	17
2 Terminology and general requirements	17
2.1 General	17
2.2 Terms, definitions and classification of phenomena	17
2.3 Preferred ratings and characteristics	47
2.3.1 Temperature ranges in degrees Celsius (°C) suitable for ambient operation	47
2.3.2 Elevated temperature ranges in degrees Celsius (°C) suitable for oven control	47
2.3.3 Frequency tolerance (1×10^{-6})	47
2.3.4 Circuit conditions	47
2.3.5 Levels of drive	47
2.3.6 Drive level dependency	49
2.3.7 Climatic category	49
2.3.8 Bump severity	49
2.3.9 Vibration severity	51
2.3.10 Shock severity	51
2.3.11 Leak rate	51
2.4 Marking	51
3 Quality assessment procedures	53
3.1 Primary stage of manufacture	53
3.2 Structurally similar components	53
3.3 Subcontracting	53
3.4 Manufacturer's approval	53
3.5 Approval procedures	53
3.5.1 General	53
3.5.2 Capability approval	53
3.5.3 Qualification approval	55
3.6 Procedures for capability approval	55
3.6.1 General	55
3.6.2 Eligibility for capability approval	55
3.6.3 Application for capability approval	55
3.6.4 Granting of capability approval	55
3.6.5 Capability manual	55
3.7 Procedures for qualification approval	55
3.7.1 General	55
3.7.2 Eligibility for qualification approval	55
3.7.3 Application for qualification approval	57
3.7.4 Granting of qualification approval	57
3.7.5 Quality conformance inspection	57
3.8 Test procedures	57
3.9 Screening requirements	57

3.10	Travaux de retouche et de réparation	56
3.10.1	Retouche	56
3.10.2	Réparation	56
3.11	Rapports certifiés de lots acceptés	56
3.12	Validité de livraison	56
3.13	Acceptation pour livraison	58
3.14	Paramètres non destinés au contrôle	58
4	Procédures d'essai et de mesure	58
4.1	Généralités	58
4.2	Autres méthodes d'essai	58
4.3	Précision de mesure	58
4.4	Conditions normales d'essai	58
4.5	Inspection visuelle	60
4.5.1	Inspection visuelle, essai A	60
4.5.2	Inspection visuelle, essai B	60
4.5.3	Inspection visuelle, essai C	60
4.6	Inspection dimensionnelle et de mesure	60
4.6.1	Dimensions, essai A	60
4.6.2	Dimensions, essai B	60
4.7	Procédures d'essais électriques	60
4.7.1	Fréquence et résistance de résonance	60
4.7.2	Influence du niveau d'excitation	60
4.7.3	Fréquence et résistance de résonance en fonction de la température	62
4.7.4	Réponses indésirables	62
4.7.5	Capacité parallèle	62
4.7.6	Fréquence et résistance avec charge	64
4.7.7	Plage de décalage de fréquence (f_{L1} , f_{L2})	64
4.7.8	Paramètres dynamiques	64
4.7.9	Résistance d'isolement	64
4.8	Méthodes d'essai mécaniques et en environnement	64
4.8.1	Robustesse des sorties (destructif)	64
4.8.2	Essais d'étanchéité (non destructifs)	66
4.8.3	Brasage (brasabilité et résistance à la chaleur de brasage) (destructif)	70
4.8.4	Variation rapide de température par immersion en utilisant la méthode de deux bains (non destructif)	70
4.8.5	Variation rapide de température avec un temps de transition prescrit (non destructif)	70
4.8.6	Secousses (destructif)	70
4.8.7	Vibrations (destructif)	72
4.8.8	Chocs (destructif)	72
4.8.9	Chutes libres (destructif)	72
4.8.10	Accélération, constante (non destructif)	72
4.8.11	Chaleur sèche (non destructif)	72
4.8.12	Chaleur humide, essai cyclique (destructif)	72
4.8.13	Froid sec (non destructif)	72
4.8.14	Séquence climatique (destructif)	74
4.8.15	Chaleur humide, essai continu (destructif)	74
4.8.16	Tenue aux solvants de nettoyage (non destructif)	74

3.10	Rework and repair work	57
3.10.1	Rework	57
3.10.2	Repair work	57
3.11	Certified records of released lots	57
3.12	Validity of release	57
3.13	Release for delivery	59
3.14	Unchecked parameters	59
4	Test and measurement procedures	59
4.1	General	59
4.2	Alternative test methods	59
4.3	Precision of measurement	59
4.4	Standard conditions for testing	59
4.5	Visual inspection	61
4.5.1	Visual test A	61
4.5.2	Visual test B	61
4.5.3	Visual test C	61
4.6	Dimensioning and gauging procedures	61
4.6.1	Dimensions, test A	61
4.6.2	Dimensions, test B	61
4.7	Electrical test procedures	61
4.7.1	Frequency and resonance resistance	61
4.7.2	Drive level dependency	61
4.7.3	Frequency and resonance resistance as a function of temperature	63
4.7.4	Unwanted responses	63
4.7.5	Shunt capacitance	63
4.7.6	Load resonance frequency and resistance	65
4.7.7	Frequency pulling range (f_{L1} , f_{L2})	65
4.7.8	Motional parameters	65
4.7.9	Insulation resistance	65
4.8	Mechanical and environmental test procedures	65
4.8.1	Robustness of terminations (destructive)	65
4.8.2	Sealing tests (non-destructive)	67
4.8.3	Soldering (solderability and resistance to soldering heat) (destructive)	71
4.8.4	Rapid change of temperature, two-fluid bath method (non-destructive)	71
4.8.5	Rapid change of temperature with prescribed time of transition (non-destructive)	71
4.8.6	Bump (destructive)	71
4.8.7	Vibration (destructive)	73
4.8.8	Shock (destructive)	73
4.8.9	Free fall (destructive)	73
4.8.10	Acceleration, steady state (non-destructive)	73
4.8.11	Dry heat (non-destructive)	73
4.8.12	Damp heat, cyclic (destructive)	73
4.8.13	Cold (non-destructive)	73
4.8.14	Climatic sequence (destructive)	75
4.8.15	Damp heat, steady state (destructive)	75
4.8.16	Immersion in cleaning solvents (non-destructive)	75

4.9 Méthodes d'essai d'endurance.....	74
4.9.1 Vieillissement (non destructif).....	74
4.9.2 Vieillissement prolongé (non destructif)	76
Bibliographie	78
Figure 1 – Symbole et circuit électrique équivalent d'un résonateur piézoélectrique près d'une résonance.....	20
Figure 2 – Impédance $ Z $, résistance R_e , réactance X_e et réactance de la branche série X_1 d'un résonateur piézoélectrique représentées en fonction de la fréquence.....	26
Figure 3 – Diagramme donnant l'impédance et l'admittance d'un résonateur piézoélectrique	28
Figure 4 – Fréquences de résonance, d'anti-résonance et de résonance avec capacité de charge.....	30
Figure 5 – Circuit électrique équivalent du résonateur piézoélectrique avec une capacité (de charge) C_L	44
Figure 6 – Outil de pliage des sorties	68
Tableau 1 – Liste des symboles utilisés pour le circuit électrique équivalent d'un résonateur piézoélectrique	36
Tableau 2 – Solutions pour les différentes fréquences caractéristiques	40
Tableau 3 – Valeurs minimales pour le rapport Q^2/r qu'il faut attendre pour des types différents de résonateurs piézoélectriques	40
Tableau 4 – Relations approximatives entre les fréquences caractéristiques et la fréquence de résonance série f_s d'un résonateur piézoélectrique	42

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60122-1:2002

4.9	Endurance test procedure.....	75
4.9.1	Ageing (non-destructive).....	75
4.9.2	Extended ageing (non-destructive).....	77
	Bibliography.....	79
	Figure 1 – Symbol and equivalent electrical circuit of a piezoelectric resonator.....	21
	Figure 2 – Impedance $ Z $, resistance R_e , reactance X_e , series arm reactance X_1 of a piezoelectric resonator as a function of frequency.....	27
	Figure 3 – Impedance and admittance diagram of a piezoelectric resonator.....	29
	Figure 4 – Resonance, anti-resonance and load resonance frequencies.....	31
	Figure 5 – Equivalent circuit of a piezoelectric resonator with a series (load) capacitance C_L	45
	Figure 6 – Terminal bend test tool.....	69
	Table 1 – List of symbols used for the equivalent electric circuit of a piezoelectric resonator.....	37
	Table 2 – Solutions for the various characteristic frequencies.....	41
	Table 3 – Minimum values for the ratio Q^2/r to be expected for various types of piezoelectric resonators.....	41
	Table 4 – Approximate relations between the characteristic frequencies and the series resonance frequency f_s of a piezoelectric resonator.....	43

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60122-1:2002

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RÉSONATEURS À QUARTZ SOUS ASSURANCE DE LA QUALITÉ –

Partie 1: Spécification générique

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60122-1 a été établie par le comité d'études 49 de la CEI: Dispositifs piézoélectriques et diélectriques pour la commande et le choix de la fréquence.

Cette troisième édition de la CEI 60122-1 annule et remplace la CEI 61178-1, parue en 1993, et la CEI 60302, parue en 1969, et en constitue une révision technique.

La CEI 60122-1 est la première partie de la nouvelle édition de la série CEI 60122 pour les résonateurs à quartz sous assurance de la qualité.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
49/551/FDIS	49/558/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

QUARTZ CRYSTAL UNITS OF ASSESSED QUALITY –**Part 1: Generic specification**

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60122-1 has been prepared by IEC technical committee 49: Piezoelectric and dielectric devices for frequency control and selection.

This third edition of IEC 60122-1 cancels and replaces IEC 61178-1 published in 1993 and IEC 60302 published in 1969 and constitutes their technical revision.

International Standard IEC 60122-1 is the first part of a new edition of the IEC standard series for quartz crystal units of assessed quality.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
49/551/FDIS	49/558/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

La CEI 60122 comprend les parties suivantes présentées sous le titre général: Résonateurs à quartz sous assurance de la qualité:

- Partie 1: Spécification générique (CEI 60122-1);
- Partie 2: Guide pour l'emploi des résonateurs à quartz pour le contrôle et la sélection de la fréquence (CEI 60122-2 à présent);
- Partie 3: Encombrements normalisés et connexions des sorties (CEI 60122-3);
- Partie 4: Spécification intermédiaire – Agrément de savoir-faire (CEI 61178-2 à présent);
- Partie 4-1: Spécification particulière cadre – Agrément de savoir-faire (CEI 61178-2-1 à présent);
- Partie 5: Spécification intermédiaire – Homologation (CEI 61178-3 à présent);
- Partie 5-1: Spécification particulière cadre – Homologation (CEI 61178-3-1 à présent)

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de spécification dans le Système CEI d'Assurance de la Qualité des Composants Electroniques (IECQ).

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60122-1:2002

IEC 60122 consists of the following parts under the general title: Quartz crystal units of assessed quality:

- Part 1: Generic specification (IEC 60122-1);
- Part 2: Guide to the use of quartz crystal units for frequency control and selection (IEC 60122-2 at present);
- Part 3: Standard outlines and lead connections (IEC 60122-3);
- Part 4: Sectional specification – Capability Approval (IEC 61178-2 at present);
- Part 4-1: Blank detail specification – Capability Approval (IEC 61178-2-1 at present);
- Part 5: Sectional specification – Qualification Approval (IEC 61178-3 at present);
- Part 5-1: Blank detail specification – Qualification Approval (IEC 61178-3-1 at present).

The QC number which appears on the front cover of this publication is the specification number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60122-1:2002

RÉSONATEURS À QUARTZ SOUS ASSURANCE DE LA QUALITÉ –

Partie 1: Spécification générique

1 Généralités

1.1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60122 spécifie les méthodes d'essai et les exigences générales pour les résonateurs à quartz dont la qualité est garantie par les procédures d'agrément de savoir-faire ou par les procédures d'homologation.

1.2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60027 (toutes les parties), *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*

CEI 60050(561):1991, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 561: Dispositifs piézoélectriques pour la stabilisation des fréquences et le filtrage*

CEI 60068-1:1988, *Essais d'environnement – Première partie: Généralités et guide*

CEI 60068-2-1:1990, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essais A: Froid*

CEI 60068-2-2:1974, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essais B: Chaleur sèche*

CEI 60068-2-3:1969, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai Ca: Essai continu de chaleur humide*

CEI 60068-2-6:1995, *Essais d'environnement – Partie 2: Essais – Essai Fc: Vibrations (sinusoïdales)*

CEI 60068-2-7:1983, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai Ga: Accélération constante*

CEI 60068-2-13:1983, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais. Essai M: Basse pression atmosphérique*

CEI 60068-2-14:1984, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai N: Variations de température*

CEI 60068-2-17:1994, *Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique – Partie 2: Essais – Essai Q: Etanchéité*

CEI 60068-2-20:1979, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai T: Soudure*

CEI 60068-2-21:1999, *Essais d'environnement – Partie 2-21: Essais – Essai U: Robustesse des sorties et des dispositifs de fixation*

QUARTZ CRYSTAL UNITS OF ASSESSED QUALITY –

Part 1: Generic specification

1 General

1.1 Scope

This part of IEC 60122 specifies the methods of test and general requirements for quartz crystal units of assessed quality using either capability approval or qualification approval procedures.

1.2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60027(all parts), *Letter symbols to be used in electrical technology*

IEC 60050(561):1991, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 561: Piezoelectric devices for frequency control and selection*

IEC 60068-1:1988, *Environmental testing – Part 1: General and guidance*

IEC 60068-2-1:1990, *Environmental testing – Part 2: Tests – Tests A: Cold*

IEC 60068-2-2:1974, *Environmental testing – Part 2: Tests – Tests B: Dry heat*

IEC 60068-2-3:1969, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test Ca: Damp heat, steady state*

IEC 60068-2-6:1995, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test Fc: Vibration (sinusoidal)*

IEC 60068-2-7:1983, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test Ga: Acceleration, steady state*

IEC 60068-2-13:1983, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test M: Low air pressure*

IEC 60068-2-14:1984, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test N: Change of temperature*

IEC 60068-2-17:1994, *Basic environmental testing procedures– Part 2: Tests – Test Q: Sealing*

IEC 60068-2-20:1979, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test T: Soldering*

IEC 60068-2-21:1999, *Environmental testing – Part 2-21: Tests – Test U: Robustness of terminations and integral mounting devices*

CEI 60068-2-27:1987, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai Ea et guide: Chocs*

CEI 60068-2-29:1987, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai Eb et guide: Secousses*

CEI 60068-2-30:1980, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai Db et guide: Essai cyclique de chaleur humide (cycle de 12 + 12 heures)*

CEI 60068-2-32:1975, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai Ed: Chute libre (méthode 1)*

CEI 60068-2-45:1980, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai XA et guide: Immersion dans les solvants de nettoyage*

CEI 60122-3:2001, *Résonateurs à quartz sous assurance de la qualité – Partie 3: Encombrements normalisés et connexions des sorties*

CEI 60444-1:1986, *Mesure des paramètres des quartz piézoélectriques par la technique de phase nulle dans le circuit en π – Première partie: Méthode fondamentale pour la mesure de la fréquence de résonance et de la résistance de résonance des quartz piézoélectriques par la technique de phase nulle dans le circuit en π*

CEI 60444-2:1980, *Mesure des paramètres des quartz piézoélectriques par la technique de phase nulle dans le circuit en π – Deuxième partie: Méthode de décalage de phase pour la mesure de la capacité dynamique des quartz*

CEI 60444-4:1988, *Mesure des paramètres des quartz piézoélectriques par la technique de phase nulle dans le circuit en π – Partie 4: Méthode pour la mesure de la fréquence de résonance à la charge f_L , et de la résistance de résonance à la charge R_L et pour le calcul des autres valeurs dérivées des quartz piézoélectriques, jusqu'à 30 MHz*

CEI 60444-5:1995, *Mesure des paramètres des résonateurs à quartz – Partie 5: Méthodes pour la détermination des paramètres électriques équivalents utilisant des analyseurs automatiques de réseaux et correction des erreurs*

CEI 60444-6:1995, *Mesure des paramètres des résonateurs à quartz – Partie 6: Mesure de la dépendance du niveau d'excitation (DNE)*

CEI 60617, *Symboles graphiques pour schémas*

CEI 61178-2:1993, *Résonateurs à quartz – Spécification dans le Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ) – Partie 2: Spécification intermédiaire – Agrément de savoir-faire*

CEI 61178-3:1993, *Résonateurs à quartz – Spécification dans le Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ) – Partie 3: Spécification intermédiaire – Homologation*

CEI QC 001001:2000, *Système CEI d'Assurance de la Qualité des Composants Electroniques (IECQ) – Règles fondamentales*

CEI QC 001002-2:1998, *IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ – Rules of procedure – Part 2: Documentation* (publiée en anglais uniquement)

CEI QC 001002-3:1998, *IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ) – Rules of procedure – Part 3: Approval Procedures* (publiée en anglais uniquement)

IEC 60068-2-27:1987, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test Ea and guidance: Shock*

IEC 60068-2-29:1987, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test Eb and guidance: Bump*

IEC 60068-2-30:1980, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test Db and guidance: Damp heat, cyclic (12 + 12-hour cycle)*

IEC 60068-2-32:1975, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test Ed: Free fall (Procedure 1)*

IEC 60068-2-45:1980, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test XA and guidance: Immersion in cleaning solvents*

IEC 60122-3:2001, *Quartz crystal units of assessed quality – Part 3: Standard outlines and lead connections*

IEC 60444-1:1986, *Measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique in a π -network – Part 1: Basic method for the measurement of resonance frequency and resonance resistance of quartz crystal units by zero phase techniques in a π -network*

IEC 60444-2:1980, *Measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique in a π -network – Part 2: Phase offset method for the measurement of motional capacitance of quartz crystal units*

IEC 60444-4:1988, *Measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique in a π -network – Part 4: Method for the measurement of the load resonance frequency f_L , load resonance resistance R_L and the calculation of other derived values of quartz crystal units, up to 30 MHz*

IEC 60444-5:1995, *Measurement of quartz crystal unit parameters – Part 5: Methods for the determination of equivalent electrical parameters using automatic network analyzer techniques and error corrections*

IEC 60444-6:1995, *Measurement of quartz crystal unit parameters – Part 6: Measurement of drive level dependence (DLD)*

IEC 60617 (all parts), *Graphical symbols for diagrams*

IEC 61178-2:1993, *Quartz crystal units – A specification in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ) – Part 2: Sectional specification – Capability approval*

IEC 61178-3:1993, *Quartz crystal units – A specification in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ) – Part 3: Sectional specification – Qualification approval*

IEC QC 001001:2000, *IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ) – Basic Rules*

IEC QC 001002-2:1998, *IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ) – Rules of Procedure – Part 2: Documentation*

IEC QC 001002-3:1998, *IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ) – Rules of Procedure – Part 3: Approval Procedures*

CEI QC 001005:2000, *Register of firms, products and services approved under the IECQ System, including ISO 9000* (publiée en anglais uniquement)

ISO 1000,1992, *Unités SI et recommandations pour l'emploi de leurs multiples et de certaines autres unités*

1.3 Ordre de priorité

En cas de divergence pour quelque raison que ce soit, les documents doivent être classés dans l'ordre de priorité suivant:

- spécification particulière;
- spécification intermédiaire;
- spécification générique;
- tout autre document international (par exemple de la CEI) auquel on fait référence.

Le même ordre de priorité s'applique aux documents nationaux équivalents.

2 Terminologie et prescriptions générales

2.1 Généralités

Les unités, symboles graphiques, symboles littéraux et terminologie doivent, autant que possible, être issus des normes suivantes: CEI 60027, CEI 60050(561), CEI 60617, ISO 1000.

2.2 Termes, définitions et classification des phénomènes

Les paragraphes suivants contiennent la terminologie additionnelle applicable aux résonateurs à quartz et décrivent certains phénomènes dans ce contexte.

2.2.1

cristal (lame)

matière piézoélectrique taillée selon une forme géométrique, des dimensions et une orientation donnée par rapport aux axes cristallographiques du cristal

2.2.2

électrode

plaque ou film électriquement conducteur en contact avec, ou à proximité d'un cristal, permettant d'appliquer à ce cristal un champ électrique

2.2.3

lame vibrante de quartz

élément de quartz monté qui vibre lorsqu'un champ électrique alternatif existe entre les électrodes

2.2.4

montage

moyens par lesquels le résonateur à quartz est monté dans son enveloppe

2.2.5

enveloppe

enveloppe protégeant le ou les résonateurs à quartz et leur monture

IEC QC 001005:2000, *Register of firms, products and services approved under the IECQ System, including ISO 9000*

ISO 1000:1992, *SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units*

1.3 Order of precedence

Where any discrepancies occur for any reason, documents shall rank in the following order of precedence:

- the detail specification;
- the sectional specification;
- the generic specification;
- any other international documents (for example of the IEC) to which reference is made.

The same order of precedence shall apply to equivalent national documents.

2 Terminology and general requirements

2.1 General

Units, graphical symbols, letter symbols and terminology shall, wherever possible, be taken from the following standards: IEC 60027, IEC 60050(561), IEC 60617 and ISO 1000.

2.2 Terms, definitions and classification of phenomena

The following paragraphs contain additional terminology applicable to quartz crystal units and describe certain phenomena in this context.

2.2.1

crystal element (crystal blank)

piezoelectric material cut to a given geometrical shape, size and orientation with respect to the crystallographic axes of the crystal

2.2.2

electrode

an electrically conductive plate or film in contact with, or in proximity to, a face of a crystal element by means of which an electric field is applied to the element

2.2.3

crystal resonator

a mounted crystal element that vibrates when an alternating electric field exists between the electrodes

2.2.4

mounting

the means by which the crystal resonator is supported (within its enclosure)

2.2.5

enclosure

the enclosure protecting the crystal resonator(s) and mounting

2.2.6

type d'enveloppe

enveloppe de résonateur de dimension et de matériau définis avec une méthode de fermeture définie

2.2.7

résonateur à quartz

lame vibrante montée dans une enveloppe fermée

2.2.8

support de quartz

composant dans lequel le résonateur à quartz est enfiché et qui assure sa fixation et ses connexions électriques

2.2.9

mode de vibration

configuration du mouvement des particules élémentaires dans un corps vibrant, résultant des contraintes appliquées à ce corps, de la fréquence de l'oscillation et des conditions aux limites. Les modes de vibration les plus courants sont:

- mode de flexion;
- mode d'extension;
- mode de cisaillement plan;
- mode de cisaillement d'épaisseur.

2.2.10

résonateur à quartz sur le mode fondamental

résonateur à quartz dans lequel le résonateur est conçu pour fonctionner à la plus basse fréquence d'un mode de vibration donné

2.2.11

résonateur à quartz sur le mode partiel

résonateur à quartz dans lequel le résonateur est conçu pour fonctionner sur un ordre plus haut que le fondamental du mode de vibration donné

2.2.12

ordre d'un partiel

rang des partiels successifs d'un mode de vibration donné dans l'ordre des fréquences croissantes en commençant par un pour le mode fondamental. Pour le mode de cisaillement et le mode d'extension, l'ordre d'un partiel est égal au quotient de la fréquence du partiel par la fréquence fondamentale, arrondi à l'entier le plus voisin

2.2.13

circuit équivalent d'un résonateur à quartz

circuit électrique qui a la même impédance que le résonateur à quartz dans la zone des fréquences de résonance et d'anti-résonance désirées. Il est représenté par une inductance, capacité et résistance en série, cette branche série étant shuntée par une capacité entre les sorties du résonateur. Les paramètres de la branche série, constituée par l'inductance, la capacité et la résistance sont exprimés respectivement par L_1 , C_1 et R_1 . Ils sont appelés «paramètres dynamiques» du résonateur à quartz. La capacité parallèle du shunt est appelée C_0 (voir la figure 1).

2.2.6**enclosure type**

a crystal enclosure of specific outline dimensions and material with a defined method of sealing

2.2.7**crystal unit**

a crystal resonator mounted in an enclosure

2.2.8**socket**

a component into which the crystal unit is inserted to hold the crystal unit and to provide electrical connection

2.2.9**mode of vibration**

the pattern of motion in a vibrating body of the individual particles resulting from stresses applied to the body, the frequency of oscillation and the boundary conditions existing. The common modes of vibration are:

- flexural;
- extensional;
- face shear;
- thickness shear.

2.2.10**fundamental crystal unit**

a crystal resonator designed to operate at the lowest order of a given mode

2.2.11**overtone crystal unit**

a crystal resonator designed to operate at a higher order than the lowest of the given mode

2.2.12**overtone order**

the numbers allotted to the successive overtones of a given mode of vibration from the ascending series of integral numbers commencing with the fundamental as unity. For shear and extensional modes, this overtone is the integral multiple of the fundamental frequency to which the overtone frequency approximates

2.2.13**crystal unit equivalent circuit**

the electric circuit which has the same impedance as the crystal unit in the region of the desired resonance and anti-resonance frequencies. It is represented by an inductance, capacitance and resistance in series, this series arm being shunted by the capacitance between the terminals of the unit. The parameters of the series branch of inductance, capacitance and resistance are given by L_1 , C_1 and R_1 respectively: these are termed "motional parameters" of the crystal unit. The shunt (parallel) capacitance is denoted by C_0 (see figure 1).

Ces paramètres sont indépendants de la fréquence pour les modes de vibration isolés. En général, le mode en question est suffisamment isolé pour permettre cette hypothèse. Lorsque ce n'est le cas, les équations et les méthodes de mesure décrites ici ne s'appliquent pas. Pour l'identification des symboles utilisés dans cette norme, voir le tableau 1.

NOTE 1 Le circuit équivalent ne représente pas toutes les caractéristiques du résonateur à quartz.

NOTE 2 Les valeurs R_e , X_e , G_p et B_p varient rapidement autour de la fréquence de résonance, où:

R_e est la résistance série du circuit équivalent du résonateur;

X_e est la réactance série du circuit équivalent du résonateur;

G_p est la conductance parallèle du circuit équivalent du résonateur;

B_p est la susceptance parallèle du circuit équivalent du résonateur;

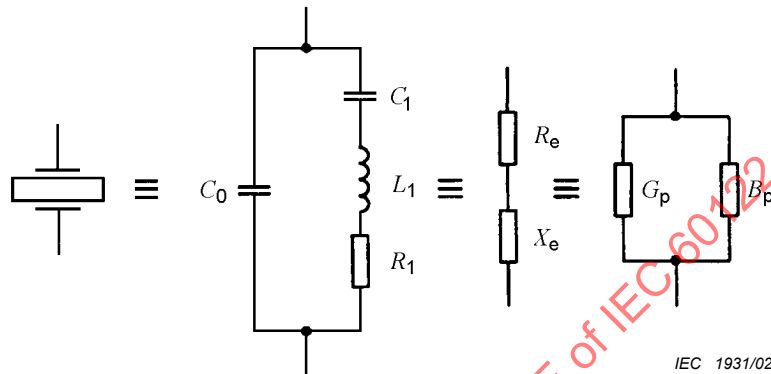


Figure 1 – Symbole et circuit électrique équivalent d'un résonateur piézoélectrique près d'une résonance

2.2.14

résistance dynamique (R_1)

résistance dans la branche dynamique (série) du circuit équivalent

2.2.15

inductance dynamique (L_1)

inductance dans la branche dynamique (série) du circuit équivalent

2.2.16

capacité dynamique (C_1)

capacité dans la branche dynamique (série) du circuit équivalent

2.2.17

capacité statique (C_0)

capacité parallèle avec la branche dynamique du circuit équivalent

The parameters are independent of frequency for isolated modes of motion. Generally, the mode in question is sufficiently isolated from other modes to permit this assumption. When this is not true, the equations and measuring methods outlined herein do not apply. For identification of symbols used in this standard, see table 1.

NOTE 1 The equivalent circuit does not represent all the characteristics of a crystal unit.

NOTE 2 The values of R_e , X_e , G_p and B_p vary rapidly around the resonance frequency, where

R_e is the equivalent circuit series resistance of the resonator;

X_e is the equivalent circuit series reactance of the resonator;

G_p is the equivalent circuit parallel conductance of the resonator;

B_p is the equivalent circuit parallel susceptance of the resonator.

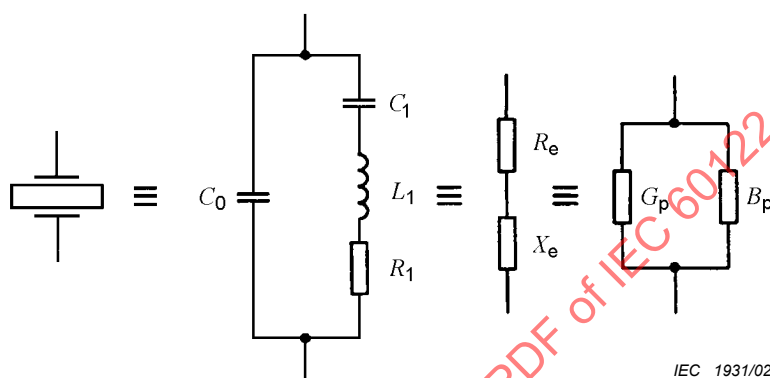


Figure 1 – Symbol and equivalent electrical circuit of a piezoelectric resonator

2.2.14

motional resistance (R_1)

the resistance in the motional (series) arm of the equivalent circuit

2.2.15

motional inductance (L_1)

the inductance in the motional (series) arm of the equivalent circuit

2.2.16

motional capacitance (C_1)

the capacitance in the motional (series) arm of the equivalent circuit

2.2.17

shunt capacitance (C_0)

the capacitance in parallel with the motional arm of the equivalent circuit

2.2.18

paramètres des résonateurs piézoélectriques

les paramètres fondamentaux C_1 , L_1 , R_1 et C_0 définissent le circuit électrique équivalent montré à la figure 1, et on peut à partir d'eux en déduire tous les autres paramètres. Pour une fréquence donnée, les paramètres du circuit électrique équivalent s'approchent généralement de valeurs constantes lorsque l'amplitude de la vibration tend vers zéro. L'amplitude que l'on peut tolérer avant que les paramètres ne soient sensiblement affectés, varie dans de grandes proportions pour des résonateurs de types différents et ne peut être déterminée que par l'expérience.

L'équation suivante qui donne l'impédance Z ou l'admittance Y :

$$Z = \frac{1}{Y} = \frac{j}{\omega C_0} \times \frac{\Omega - j\delta}{1 - \Omega + j\delta} \quad (1)$$

du circuit électrique équivalent du résonateur piézoélectrique est l'équation de base à partir de laquelle sont écrites les relations entre les divers paramètres.

Dans l'équation (1):

$$\Omega = \frac{f^2 - f_s^2}{f_p^2 - f_s^2} \quad \text{et} \quad \delta = 2\pi f C_0 R_1$$

sont respectivement le facteur de fréquence normalisé et le facteur d'amortissement normalisé. Voir le tableau 1 pour des définitions de f_p , f_s et des autres symboles utilisés dans l'équation (1) et pour d'autres paramètres essentiels. Les fréquences caractéristiques de l'équation (1) sont définies dans le tableau 2.

La valeur de l'impédance du circuit électrique équivalent ($|Z|$), sa composante résistive (R_e), sa composante réactive (X_e), et la réactance X_1 de la branche L_1 , C_1 , R_1 sont représentées graphiquement en fonction de la fréquence à la figure 2, pour définir les fréquences caractéristiques différentes. $|Z_m|$ et $|Z_n|$ indiquent respectivement l'impédance minimale et maximale, et R_r , R_a dénotent les impédances à l'angle de phase zéro. Ces courbes n'ont néanmoins qu'un caractère qualitatif et elles ne représentent pas un résonateur piézoélectrique particulier.

On a, pour mieux exposer les faits, représenté à la figure 3, les cercles d'impédance et d'admittance d'un résonateur piézoélectrique. Cependant, cette représentation par un cercle de l'impédance ou de l'admittance d'un résonateur piézoélectrique n'est valable que si le diamètre du cercle dans le diagramme relatif à l'admittance est grand en comparaison de la variation de $2\pi f C_0$ dans la gamme de résonance ou si $r \ll Q^2$; ces conditions sont satisfaites dans la plupart des résonateurs. Si ces dernières ne sont pas remplies, la courbe donnant l'admittance présente une allure cissoïdale. Dans le reste de cette norme on suppose que l'impédance (ou l'admittance) du résonateur peuvent être représentées par un diagramme en forme de cercle. Le tableau 3 donne les valeurs pour Q , r , et Q^2/r pour des résonateurs de types divers montrant ainsi que cette hypothèse est pratiquement valable pour tous les cas.

Il est nécessaire de faire des approximations lorsque l'on déduit des équations pratiques applicables pour des usages généraux. C'est la somme des erreurs imputables à ces approximations et aux erreurs de mesures qui détermine la précision globale des paramètres, déduits par expérience.

2.2.18

parameters of piezoelectric resonators

the fundamental parameters C_1 , L_1 , R_1 and C_0 define the equivalent electric circuit shown in figure 1, and all other parameters may be derived from them. At a given frequency, the parameters of the equivalent electric circuit generally approach constant values as the amplitude of vibration approaches zero. The amplitude which can be tolerated before the parameters are appreciably affected varies widely between resonators of various types and can only be determined by experiment.

The equation for the impedance Z or admittance Y :

$$Z = \frac{1}{Y} = \frac{j}{\omega C_0} \times \frac{\Omega - j\delta}{1 - \Omega + j\delta} \quad (1)$$

of the equivalent electric circuit of the piezoelectric resonator is the basic equation describing the relationships between the various parameters.

In equation (1):

$$\Omega = \frac{f^2 - f_s^2}{f_p^2 - f_s^2} \quad \text{and} \quad \delta = 2\pi f C_0 R_1$$

are the normalized frequency factor and the normalized damping factor, respectively. See table 1, for definitions of f_p , f_s , and the other symbols used in equation (1) and for other essential parameters. The characteristic frequencies of equation (1) are defined in table 2.

The magnitude of the impedance of the equivalent electric network ($|Z|$), its resistive component (R_e), its reactive component (X_e), and the reactance X_1 of the L_1 , C_1 , R_1 branch are plotted as functions of frequency in figure 2, for the purpose of defining the different characteristic frequencies. $|Z_m|$ and $|Z_n|$ denote minimum and maximum impedance respectively, and R_r , R_a the impedances at zero phase angle. These curves, however, have only qualitative character and do not represent a particular piezoelectric resonator.

For further clarification, the impedance and admittance circles of a piezoelectric resonator are reproduced in figure 3. However, the circle representation of the impedance or admittance of a piezoelectric resonator is valid only if the circle diameter of the admittance diagram is large compared with the change of $2\pi f C_0$ in the resonance range or if $r \ll Q^2$, which is fulfilled in most resonators. If the latter conditions are not fulfilled, the admittance curve shows a cissoidal character. Throughout the remainder of this standard, it is assumed that the impedance (or admittance) of the resonator can be represented by a circle diagram. Table 3 gives data for Q , r , and Q^2/r for various types of resonators, indicating that this assumption is valid for all practical cases.

It is necessary to make approximations in deriving practical equations for general use. It is the error of these approximations, in addition to the errors of instrumentation that govern the overall accuracy of the experimentally derived parameters.

Comme une première approximation est suffisante pour la plupart des applications pratiques, les hypothèses suivantes peuvent être faites:

$$f_m = f_r = f_s \quad \text{et} \quad f_a = f_n = f_p$$

Des relations plus exactes entre les fréquences caractéristiques f_m , f_r , f_a , f_p , f_n , et la fréquence de résonance série f_s d'un résonateur, valables pour le facteur de mérite $M > 10$ et le rapport de capacité $r > 10$, sont indiquées dans le tableau 4. Ces relations ont été déduites par divers auteurs à condition que $M \gg 1$.

La séparation entre la fréquence de résonance parallèle et la fréquence de résonance série est donnée par:

$$\frac{f_p^2 - f_s^2}{f_s^2} = \frac{C_1}{C_0} = \frac{1}{r} \quad (2)$$

L'approximation:

$$\begin{aligned} \frac{f_p - f_s}{f_s} &= \sqrt{1 + r^{-1}} - 1 \\ &= \frac{1}{2r} \left(1 - \frac{1}{4r} + \dots \right) \approx \frac{1}{2r} \\ &= \frac{1}{2} \frac{C_1}{C_0} \end{aligned} \quad (3)$$

peut être utilisée pour des valeurs de r plus grandes (par exemple quand r est supérieur à 25, l'erreur est inférieure à 1 %).

2.2.19

fréquence de résonance (f_r)

la plus basse des deux fréquences du résonateur à quartz seul, dans des conditions spécifiées, pour laquelle le résonateur à quartz est équivalent à une résistance pure

2.2.20

résistance de résonance (R_r)

la résistance du résonateur à quartz seul à la fréquence de résonance f_r

2.2.21

fréquence d'anti-résonance (f_a)

la plus haute des deux fréquences du résonateur à quartz seul, dans des conditions spécifiées, pour laquelle le résonateur à quartz est équivalent à une résistance pure

2.2.22

capacité de charge (C_L)

la capacité externe effective associée au résonateur à quartz qui détermine la fréquence de résonance à la charge f_L

2.2.23

fréquence de résonance à la charge (f_L)

une des deux fréquences du résonateur à quartz associé à une capacité de charge série ou parallèle, dans des conditions spécifiées, pour laquelle la combinaison est équivalente à une résistance pure. Cette fréquence est la plus basse des deux fréquences lorsque la capacité de charge est en série et la plus haute lorsqu'elle est en parallèle (voir la figure 4).

As a first approximation sufficient for many practical purposes, the following assumptions can be made:

$$f_m = f_r = f_s \quad \text{and} \quad f_a = f_n = f_p$$

More exact relations between the characteristic frequencies f_m , f_r , f_a , f_p , f_n , and the series resonance frequency f_s of a resonator, valid for the figure of merit $M > 10$ and the capacitance ratio $r > 10$, are shown in table 4. These relationships have been derived by various authors under the assumption that $M \gg 1$.

The separation between parallel and series resonance frequencies is given by:

$$\frac{f_p^2 - f_s^2}{f_s^2} = \frac{C_1}{C_0} = \frac{1}{r} \quad (2)$$

The approximation:

$$\begin{aligned} \frac{f_p - f_s}{f_s} &= \sqrt{1 + r^{-1}} - 1 \\ &= \frac{1}{2r} \left(1 - \frac{1}{4r} + \dots \right) \approx \frac{1}{2r} \\ &= \frac{1}{2} \frac{C_1}{C_0} \end{aligned} \quad (3)$$

can be used for larger values of r (for example, when r is greater than 25, the error is less than 1 %).

2.2.19

resonance frequency (f_r)

the lower of the two frequencies of the crystal unit alone, under specified conditions, at which the electrical impedance of the crystal unit is resistive

2.2.20

resonance resistance (R_r)

the resistance of the crystal unit alone at the resonance frequency f_r

2.2.21

anti-resonance frequency (f_a)

the higher of the two frequencies of the crystal unit alone, under specified conditions, at which the electrical impedance of the crystal unit is resistive

2.2.22

load capacitance (C_L)

the effective external capacitance associated with the crystal unit which determines the load resonance frequency f_L

2.2.23

load resonance frequency (f_L)

one of the two frequencies of a crystal unit in association with a series or with a parallel load capacitance, under specified conditions at which the electrical impedance of the combination is resistive. The load resonance frequency is the lower of the two frequencies when the load capacitance is in series and the higher when it is in parallel (see figure 4).

Pour la valeur spécifiée de la capacité de charge C_L , ces fréquences sont identiques pour toutes les applications pratiques et sont données par:

$$\frac{1}{f_L} = 2\pi \sqrt{\frac{L_1 C_1 (C_0 + C_L)}{C_1 + C_0 + C_L}} \quad (4)$$

NOTE 1 Les fréquences définies en 2.2.19, 2.2.21 et 2.2.23 sont données comme les termes les plus utilisés habituellement. Il y a beaucoup d'autres fréquences associées aux résonateurs à quartz et pour en obtenir une explication complète, il convient de consulter les tableaux 2 et 4.

NOTE 2 Il convient de consulter le tableau 1, la CEI 60444-1 et la CEI 60444-5 lorsque des précisions plus grandes sont exigées ou lorsque des données secondaires doivent être dérivées des mesures de fréquence (par exemple, les valeurs des paramètres motionnels d'un résonateur à quartz).

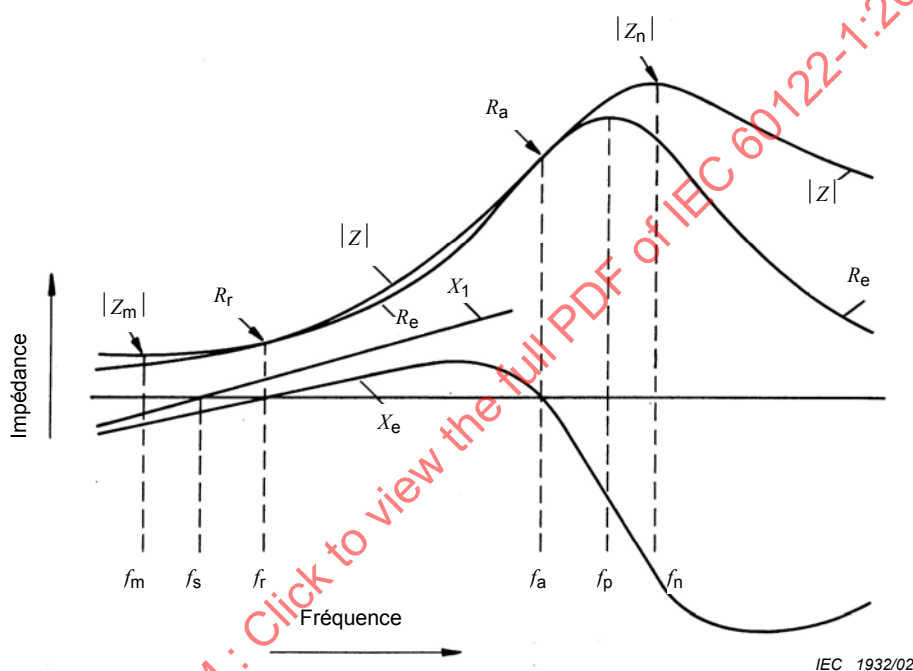


Figure 2 – Impédance $|Z|$, résistance R_e , réactance X_e et réactance de la branche série X_1 d'un résonateur piézoélectrique représentées en fonction de la fréquence

For a given value of load capacitance C_L , these frequencies are identical for all practical purposes and are given by the expression

$$\frac{1}{f_L} = 2\pi \sqrt{\frac{L_1 C_1 (C_0 + C_L)}{C_1 + C_0 + C_L}} \quad (4)$$

NOTE 1 The frequencies defined in 2.2.19, 2.2.21 and 2.2.23 are listed as being the terms more commonly used. The frequencies associated with a quartz crystal are numerous and for a full explanation tables 2 and 4 should be consulted.

NOTE 2 When higher accuracies are required or secondary data (for example, values of crystal unit motional parameters) are to be derived from the frequency measurements, table 1, IEC 60444-1 and IEC 60444-5 should be consulted.

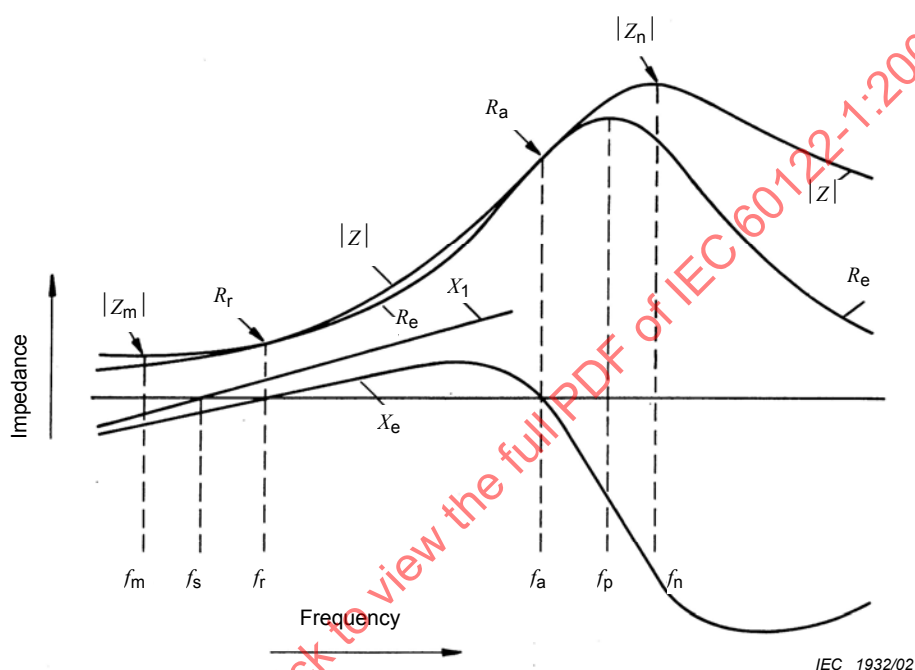
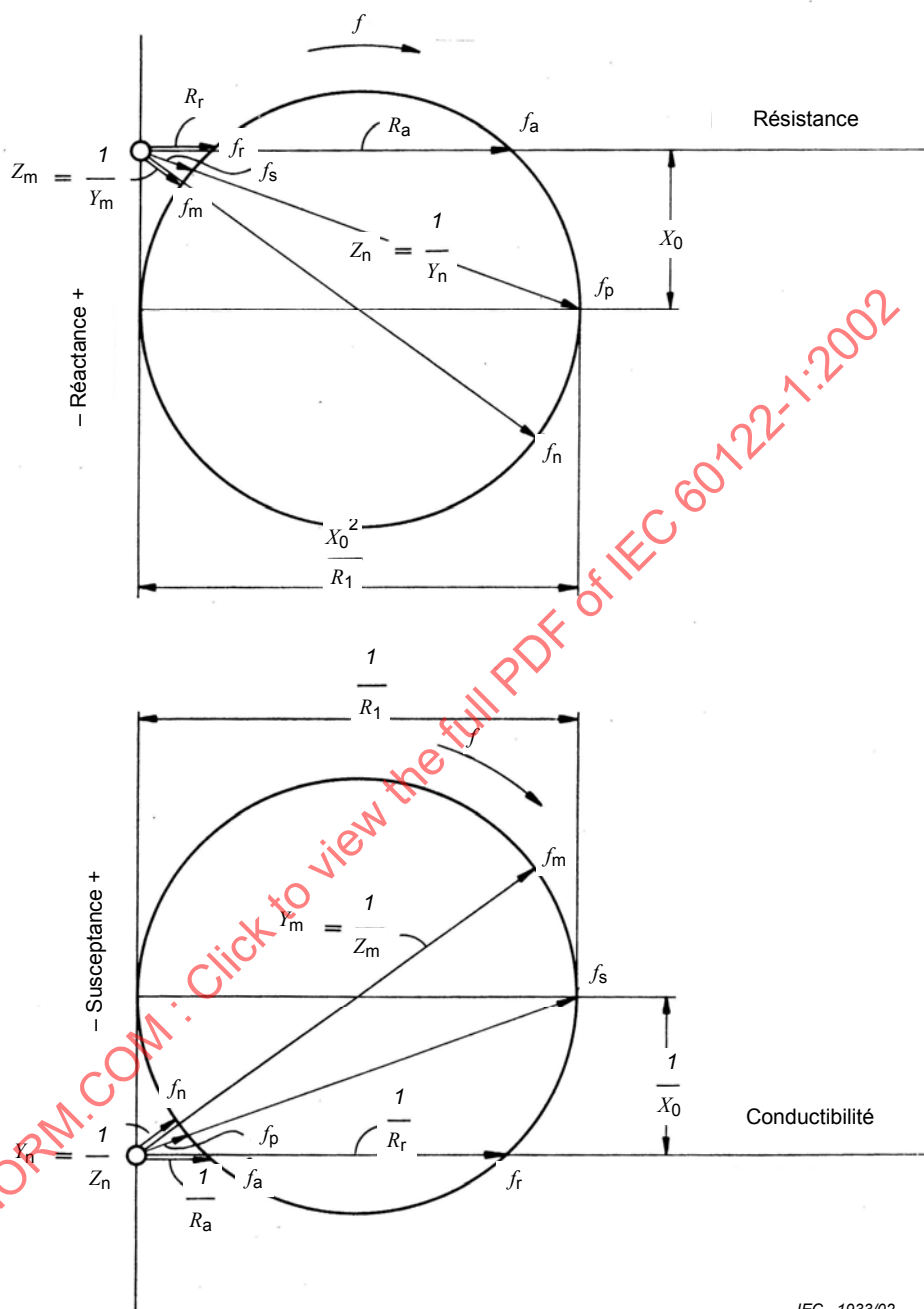


Figure 2 – Impedance $|Z|$, resistance R_e , reactance X_e , series arm reactance X_1 of a piezoelectric resonator as a function of frequency



IEC 1933/02

Figure 3 – Diagramme donnant l'impédance et l'admittance d'un résonateur piézoélectrique

Les symboles sont conformes à ceux utilisés au tableau 1 et à la figure 2.

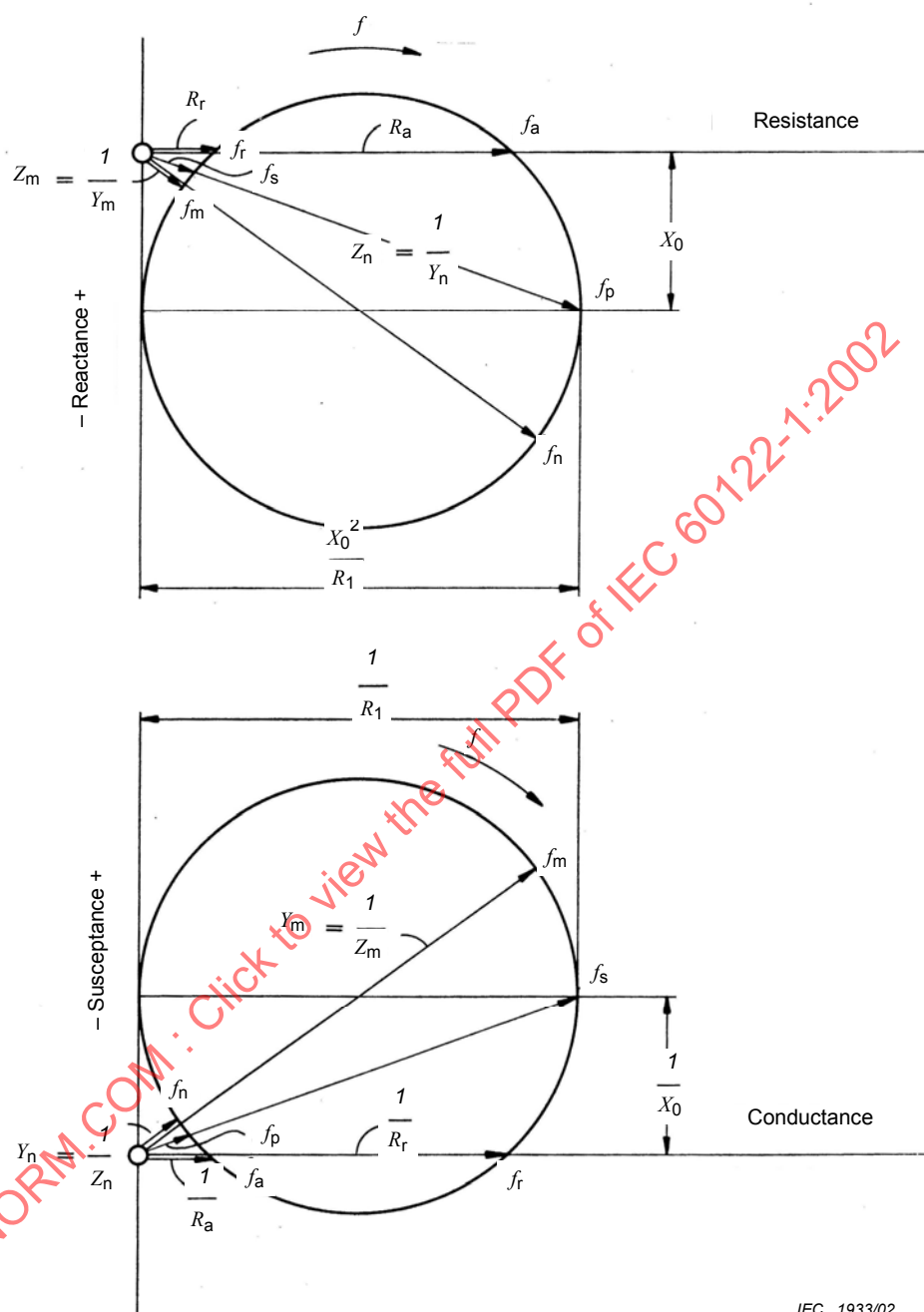
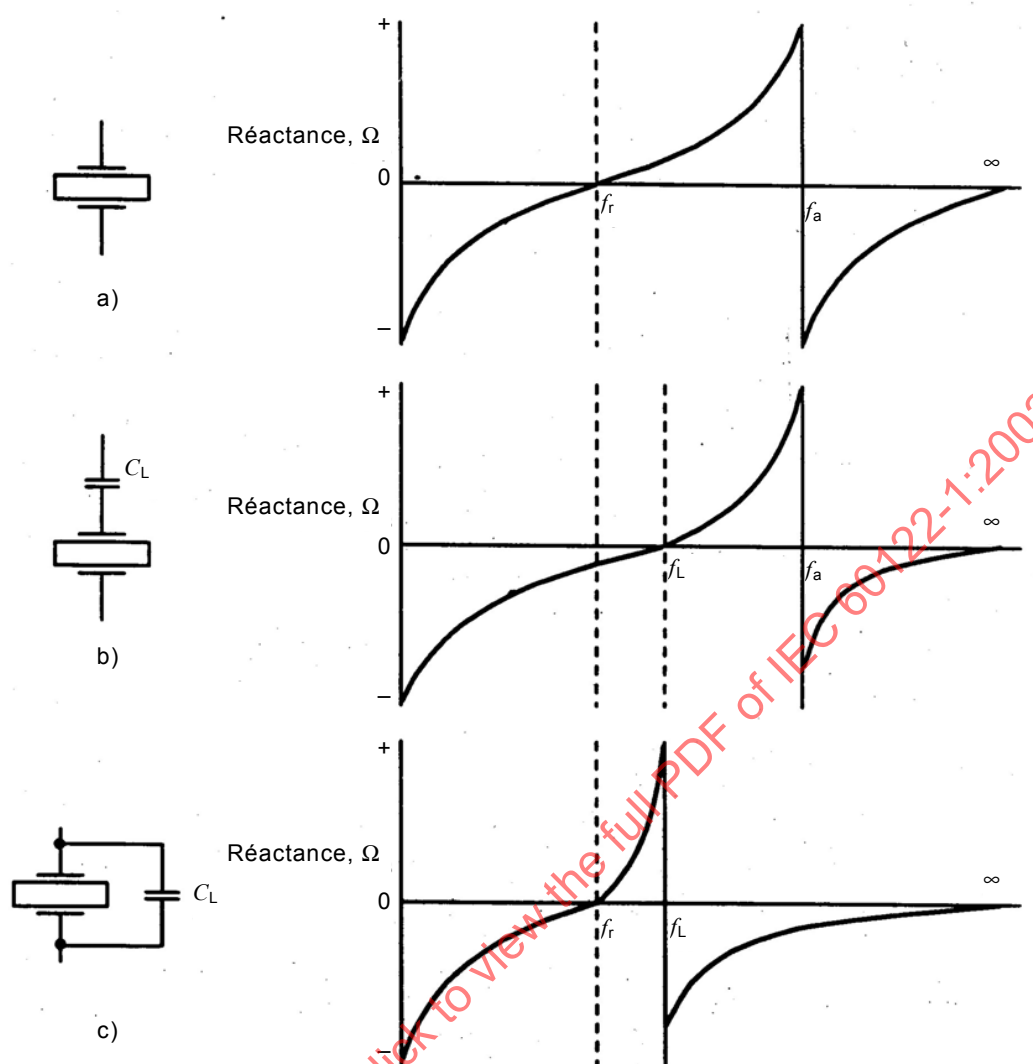


Figure 3 – Impedance and admittance diagram of a piezoelectric resonator

The symbols conform with those in table 1 and figure 2.



IEC 1934/02

NOTE 1 Les valeurs des capacités de charge montrées en b) et c) sont égales.

NOTE 2 Voir 2.2.19, 2.2.21 et 2.2.23.

Figure 4 – Fréquences de résonance, d'anti-résonance et de résonance avec capacité de charge

2.2.24

résistance de résonance à la charge (R_L)

résistance du résonateur à quartz en série avec une capacité externe donnée à la fréquence de résonance à la charge f_L

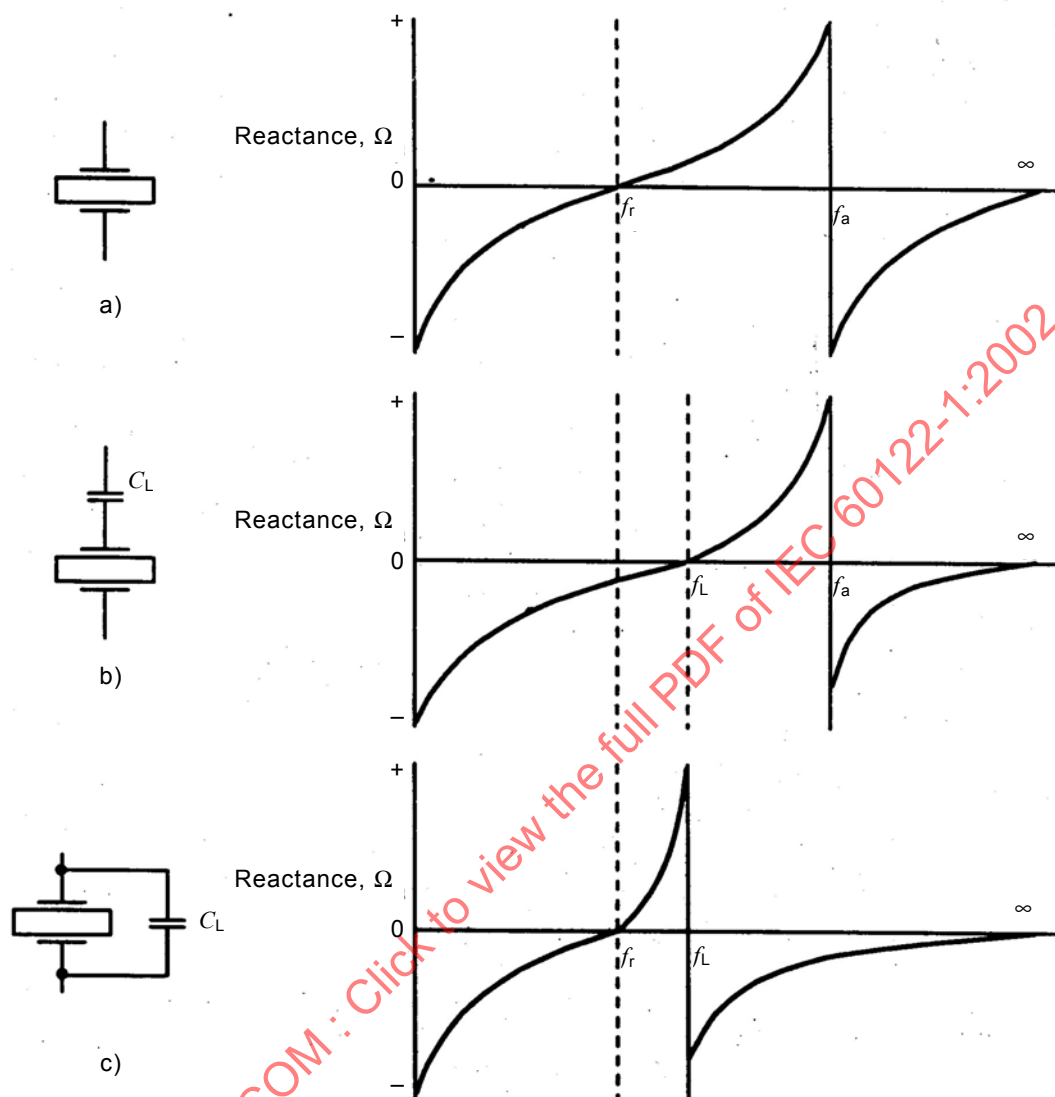
NOTE La valeur de R_L est liée à la valeur de R_r avec une bonne approximation par l'expression suivante:

$$R_L \cong R_r \left(1 + \frac{C_0}{C_L} \right)^2 \quad (5)$$

2.2.25

fréquence nominale (f_{nom})

fréquence attribuée au résonateur à quartz par le fabricant



IEC 1934/02

NOTE 1 The values of load capacitances shown in b) and c) are equal.

NOTE 2 See 2.2.19, 2.2.21 and 2.2.23.

Figure 4 – Resonance, anti-resonance and load resonance frequencies

2.2.24

load resonance resistance (R_L)

the resistance of the crystal unit in series with a stated external capacitance at the load resonance frequency f_L .

NOTE To a close approximation the value of R_L is related to the value of R_r by the expression:

$$R_L \cong R_r \left(1 + \frac{C_0}{C_L} \right)^2 \quad (5)$$

2.2.25

nominal frequency (f_{nom})

the frequency assigned to the crystal unit by the manufacturer

2.2.26

fréquence de fonctionnement (f_w)

fréquence de fonctionnement du résonateur à quartz avec ses circuits associés

2.2.27

décalage de la fréquence de résonance à la charge (Δf_L)

$$\Delta f_L = f_L - f_r \quad (6)$$

Sa valeur approximative est:

$$\Delta f_L \cong \frac{f_r C_1}{2(C_0 + C_L)} \quad (7)$$

Quand on se sert du décalage de fréquence de résonance à la charge Δf_L , on peut remplacer l'indice inférieur L par la valeur réelle de la capacité de charge utilisée (en picofarads); on écrit ainsi Δf_{30} ou Δf_{20} par exemple.

2.2.28

décalage relatif de la fréquence de résonance à la charge (D_L)

$$D_L = \frac{f_L - f_r}{f_r} \quad (8)$$

Sa valeur approximative est:

$$D_L \cong \frac{C_1}{2(C_0 + C_L)} \quad (9)$$

Quand on se sert du décalage relatif de la fréquence de résonance à la charge D_L , on peut remplacer l'indice inférieur L par la valeur de la capacité de charge utilisée. Exemple: D_{30} pour 30 pF.

2.2.29

plage de décalage de fréquence ($\Delta f_{L1,L2}$)

$$\Delta f_{L1,L2} = |f_{L1} - f_{L2}| \quad (10)$$

Sa valeur approximative est:

$$\Delta f_{L1,L2} = \left| \frac{f_r C_1 (C_{L2} - C_{L1})}{2(C_0 + C_{L1})(C_0 + C_{L2})} \right| \quad (11)$$

Pour désigner la valeur de la plage de décalage de fréquence entre deux capacités de charge données, par exemple 20 pF et 30 pF, on écrira: $\Delta f_{20,30}$.

2.2.30

plage de décalage de fréquence relative ($D_{L1,L2}$)

$$D_{L1,L2} = \left| \frac{f_{L1} - f_{L2}}{f_r} \right| = |D_{L1} - D_{L2}| \quad (12)$$

2.2.26**working frequency (f_w)**

the operational frequency of the crystal unit together with associated circuits

2.2.27**load resonance frequency offset (Δf_L)**

$$\Delta f_L = f_L - f_r \quad (6)$$

It can be calculated approximately from

$$\Delta f_L \cong \frac{f_r C_1}{2(C_0 + C_L)} \quad (7)$$

In usage, the load resonance frequency offset Δf_L for a given value of load capacitance can be written as, for instance, Δf_{30} or Δf_{20} to indicate the actual value of load capacitance in picofarads involved.

2.2.28**fractional load resonance frequency offset (D_L)**

$$D_L = \frac{f_L - f_r}{f_r} \quad (8)$$

It can be calculated approximately from

$$D_L \cong \frac{C_1}{2(C_0 + C_L)} \quad (9)$$

This can also be written as, for instance, D_{30} to indicate the fractional load resonance frequency offset D_L with a load capacitance of 30 pF.

2.2.29**frequency pulling range ($\Delta f_{L1,L2}$)**

$$\Delta f_{L1,L2} = |f_{L1} - f_{L2}| \quad (10)$$

It can be calculated approximately from:

$$\Delta f_{L1,L2} = \left| \frac{f_r C_1 (C_{L2} - C_{L1})}{2(C_0 + C_{L1})(C_0 + C_{L2})} \right| \quad (11)$$

This can also be written as, for instance $\Delta f_{20,30}$ to indicate the frequency pulling range between load capacitances of 20 pF and 30 pF

2.2.30**fractional pulling range ($D_{L1,L2}$)**

$$D_{L1,L2} = \left| \frac{f_{L1} - f_{L2}}{f_r} \right| = |D_{L1} - D_{L2}| \quad (12)$$

Sa valeur approximative est:

$$D_{L1,L2} = \left| \frac{C_1(C_{L2} - C_{L1})}{2(C_0 + C_{L1})(C_0 + C_{L2})} \right| \quad (13)$$

Pour désigner la valeur de la plage de décalage de fréquence relative entre deux capacités de charge données, par exemple 20 pF et 30 pF, on écrira: $D_{20,30}$.

2.2.31

sensibilité de fréquence relative (S)

$$S = \frac{dD_L}{dC_L} \cong \frac{-C_1}{2(C_0 + C_L)^2} \quad (14)$$

Pour désigner la valeur de la sensibilité de fréquence relative pour une capacité de charge donnée, par exemple 30 pF, on écrira: S_{30}

2.2.32

gamme de températures de fonctionnement

gamme de températures mesurées sur l'enveloppe dans laquelle le résonateur à quartz doit être dans les tolérances spécifiées

2.2.33

gamme de températures de service

gamme de températures mesurées sur l'enveloppe, dans laquelle le résonateur à quartz fonctionne, sans nécessairement être dans les tolérances spécifiées et ne subit pas de dégradation permanente

2.2.34

gamme de températures de stockage

températures minimales et maximales, mesurées sur l'enveloppe et auxquelles le résonateur peut être stocké sans détérioration ou dégradation de ses performances

2.2.35

température de référence

température à laquelle certains relevés de mesures de résonateurs à quartz sont effectués. Pour les résonateurs à température contrôlée, la température de référence est le point milieu de la gamme de températures contrôlée. Pour les résonateurs à température non contrôlée, la température de référence est normalement $25\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$.

2.2.36

niveau d'excitation

mesure des conditions de fonctionnement imposées au résonateur. Ceci peut s'exprimer en termes de passage de courant ou puissance dissipée dans le résonateur

2.2.37

influence du niveau d'excitation

l'influence du niveau d'excitation (DLD) résulte dans le changement des conditions du niveau d'excitation sur la résistance de résonance du résonateur. Ce paramètre peut s'exprimer en définissant le rapport de résistance entre deux niveaux d'excitation spécifiés. Le rapport est représenté comme suit:

$$\frac{R_{r1}}{R_{r2}}$$

où

R_{r1} est la résistance au niveau d'excitation le plus bas;

R_{r2} est la résistance au niveau d'excitation le plus haut.

It can be calculated approximately from:

$$D_{L1,L2} = \left| \frac{C_1(C_{L2} - C_{L1})}{2(C_0 + C_{L1})(C_0 + C_{L2})} \right| \quad (13)$$

This can be written as, for instance, $D_{20,30}$, to indicate the fractional pulling range between load capacitances of 20 pF and 30 pF

2.2.31

pulling sensitivity (S)

$$S = \frac{dD_L}{dC_L} \cong \frac{-C_1}{2(C_0 + C_L)^2} \quad (14)$$

This can be written as, for instance, S_{30} , to indicate the pulling sensitivity at a load capacitance of 30 pF

2.2.32

operating temperature range

the range of temperatures as measured on the enclosure, over which the crystal unit shall be within the specified tolerances

2.2.33

operable temperature range

the range of temperatures as measured on the enclosure over which the crystal unit will not sustain permanent damage though not necessarily functioning within the specified tolerances

2.2.34

storage temperature range

the minimum and maximum temperatures, as measured on the enclosure, at which the crystal unit may be stored without deterioration or damage to its performance

2.2.35

reference temperature

the temperature at which certain crystal measurements are made. For controlled temperature units, the reference temperature is the mid-point of the controlled temperature range. For non-controlled temperature units, the reference temperature is normally $25\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$

2.2.36

level of drive

a measure of the conditions imposed upon the crystal unit. This may be expressed in terms of current through or power dissipated in the crystal element

2.2.37

drive level dependency

drive level dependency (DLD) is the effect of changes in drive level conditions upon the resonance resistance of the crystal unit. This parameter can be specified by defining the ratio of resistance between two specified drive levels. This ratio is represented by the expression:

$$\frac{R_{r1}}{R_{r2}}$$

where

R_{r1} is the resistance at the lower level of drive;

R_{r2} is the resistance at the higher level of drive.

2.2.38

réponse indésirable

fréquence de résonance d'un résonateur autre que la fréquence associée à la fréquence de fonctionnement

2.2.39

tolérance de fréquence

écart maximal autorisé de la fréquence de fonctionnement dû à une cause spécifiée ou à une combinaison de causes. La tolérance de fréquence s'exprime habituellement en millionièmes (1×10^{-6}) de la fréquence nominale

NOTE Les tolérances employées normalement sont:

- écart de la fréquence nominale à la température de référence dans des conditions spécifiées;
- écart dans la gamme de températures de la fréquence à la température de référence spécifiée;
- écart en fonction du vieillissement dans des conditions spécifiées;
- écart de la fréquence nominale dû à toutes causes (tolérance totale).

Tableau 1 – Liste des symboles utilisés pour le circuit électrique équivalent d'un résonateur piézoélectrique

Symboles	Définition	Unités SI	Références		
			Equations	Tableaux	Figures
B_p	Susceptance parallèle équivalente du résonateur	S		2	1
C_0	Capacité statique dans le circuit électrique équivalent	F	2, 3		1, 5
C_1	Capacité dynamique dans le circuit électrique équivalent	F	2, 3		1, 5
f	Fréquence	Hz			3
f_a	Fréquence d'anti-résonance, susceptance zéro	Hz		2, 4	2, 3
f_m	Fréquence d'admittance maximale (impédance minimale)	Hz		2, 4	2, 3
f_n	Fréquence d'admittance minimale (impédance maximale)	Hz		2, 4	2, 3
f_p	Fréquence de résonance parallèle (sans perte)	Hz	2, 3	2, 4	2, 3
	$\frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 \frac{C_1 C_0}{C_1 + C_0}}}$				
f_r	Fréquence de résonance, susceptance zéro	Hz		2, 4	2, 3, 4
f_s	Fréquence de résonance série (dynamique)	Hz	2, 3	2, 4	2, 3
	$\frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C_1}}$				
G_p	Conductibilité parallèle équivalente				1
L_1	Inductance dynamique dans le circuit électrique équivalent	H			1, 5
M	Facteur de mérite	Sans dimension		3, 4	
	$M = \frac{Q}{r}$ d'un résonateur				

2.2.38**unwanted response**

a state of resonance of a crystal resonator other than that associated with the working frequency

2.2.39**frequency tolerance**

the maximum permissible deviation of the working frequency due to a specified cause or a combination of causes. The frequency tolerance is usually stated in parts per million (1×10^{-6}) of the nominal frequency

NOTE The tolerances normally used are as follows:

- deviation from nominal frequency at the reference temperature under specified conditions;
- deviation over the temperature range from the frequency at the specified reference temperature;
- deviation as a result of ageing under specified conditions;
- deviation from nominal frequency due to all causes (overall tolerance).

Table 1 – List of symbols used for the equivalent electric circuit of a piezoelectric resonator

Symbols	Meaning	SI units	References		
			Equations	Tables	Figures
B_p	Equivalent parallel susceptance of resonator	S		2	1
C_0	Shunt (parallel) capacitance in the equivalent electric circuit	F	2, 3		1, 5
C_1	Motional capacitance in the equivalent electric circuit	F	2, 3		1, 5
f	Frequency	Hz			3
f_a	Antiresonance frequency, zero susceptance	Hz		2, 4	2, 3
f_m	Frequency of maximum admittance (minimum impedance)	Hz		2, 4	2, 3
f_n	Frequency of minimum admittance (maximum impedance)	Hz		2, 4	2, 3
f_p	Parallel resonance frequency (lossless)	Hz	2, 3	2, 4	2, 3
	$\frac{1}{2\pi\sqrt{L_1\frac{C_1C_0}{C_1+C_0}}}$				
f_r	Resonance frequency, zero susceptance	Hz		2, 4	2, 3, 4
f_s	Motional (series) resonance frequency	Hz	2, 3	2, 4	2, 3
	$\frac{1}{2\pi\sqrt{L_1C_1}}$				
G_p	Equivalent parallel conductance of resonator				1
L_1	Motional inductance in the equivalent electric circuit	H			1, 5
M	Figure of merit of a resonator	Dimensionless		3, 4	
	$M = \frac{Q}{r}$				

Symboles	Définition	Unités SI	Références		
			Equations	Tableaux	Figures
Q	Facteur de qualité $Q = \frac{W_s L_1}{R_1}$	Sans dimension		3	
r	Rapport de capacité: $r = \frac{C_0}{C_1}$	Sans dimension	2, 3	2, 3, 4	
R_a	Impédance pour l'angle de phase zéro au voisinage de l'anti-résonance	Ω			2, 3
R_e	Résistance série équivalente du résonateur	Ω			1, 2
R_r	Impédance à f_r , pour l'angle de phase zéro	Ω			2, 3
R_1	Résistance dynamique dans le circuit électrique équivalent	Ω	15	2	1, 3, 5
X_e	Réactance série équivalente du résonateur	Ω			1, 2
X_0	Réactance de la capacité statique à la résonance série: $X_0 = \frac{1}{\omega_s C_0}$	Ω			3
X_1	Réactance du bras dynamique série du résonateur: $X_1 = \omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1}$	Ω		2	2
Y	Admittance du résonateur: $Y = G_p + jB_p = \frac{1}{Z}$	S	1		
Y_m	Admittance maximale du résonateur	S			3
Y_n	Admittance minimale du résonateur	S			3
Z	Impédance du résonateur: $Z = R_e + jX_e$	Ω	1		
Z_m	Impédance minimale du résonateur	Ω			2, 3
Z_n	Impédance maximale du résonateur	Ω			2, 3
$ Z $	Valeur absolue de l'impédance du résonateur: $Z = \sqrt{R_e^2 + X_e^2}$	Ω		2	2
$ Z_m $	Valeur absolue de l'impédance à f_m (impédance minimale)	Ω			2
$ Z_n $	Valeur absolue de l'impédance à f_n (impédance maximale)	Ω			2
δ	Coefficient normalisé d'amortissement: $\delta = \omega C_0 R_1$	Sans dimension	1	2	
Ω	Facteur de fréquence normalisé: $\Omega = \frac{f^2 - f_s^2}{f_p^2 - f_s^2}$	Sans dimension	1	2	
ω	Pulsation: $\omega = 2\pi f$	rad/s		2	
ω_s	Pulsation à la résonance dynamique: $\omega_s = 2\pi f_s$	rad/s			
C_L	Capacité de charge	F	4, 15	1	4, 5
f_L	Fréquence de résonance d'une combinaison du résonateur avec une capacité de charge C_L $f_L = f_s \sqrt{1 + \frac{C_1}{C_0 + C_L}}$	Hz	15	1	4

Symbols	Meaning	SI units	References		
			Equations	Tables	Figures
Q	Quality factor: $Q = \frac{W_s L_1}{R_1}$	Dimensionless		3	
r	Capacitance ratio: $r = \frac{C_0}{C_1}$	Dimensionless	2, 3	2, 3, 4	
R_a	Impedance at zero phase angle near antiresonance	Ω			2, 3
R_e	Equivalent series resistance of resonator	Ω			1, 2
R_r	Impedance at f_r , zero phase angle	Ω			2, 3
R_1	Motional resistance in the equivalent electric circuit	Ω	15	2	1, 3, 5
X_e	Equivalent series reactance of resonator	Ω			1, 2
X_0	Reactance of shunt (parallel) capacitance at series resonance: $X_0 = \frac{1}{\omega_s C_0}$	Ω			3
X_1	Reactance of motional series arm of resonator: $X_1 = \omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1}$	Ω		2	2
Y	Admittance of resonator: $Y = G_p + jB_p = \frac{1}{Z}$	S	1		
Y_m	Maximum admittance of resonator	S			3
Y_n	Minimum admittance of resonator	S			3
Z	Impedance of resonator: $Z = R_e + jX_e$	Ω	1		
Z_m	Minimum impedance of resonator	Ω			2, 3
Z_n	Maximum impedance of resonator	Ω			2, 3
$ Z $	Absolute value of impedance of resonator: $Z = \sqrt{R_e^2 + X_e^2}$	Ω		2	2
$ Z_m $	Absolute value of impedance at f_m (minimum impedance)	Ω			2
$ Z_n $	Absolute value of impedance at f_n (maximum impedance)	Ω			2
δ	Normalized damping factor: $\delta = \omega C_0 R_1$	Dimensionless	1	2	
Ω	Normalized frequency factor: $\Omega = \frac{f^2 - f_s^2}{f_p^2 - f_s^2}$	Dimensionless	1	2	
ω	Circular (angular) frequency: $\omega = 2\pi f$	rad/s		2	
ω_s	Circular frequency at motional resonance: $\omega_s = 2\pi f_s$	rad/s			
C_L	Load capacitance	F	4, 15	1	4, 5
f_L	Load resonance frequency of combination of resonator and C_L $f_L = f_s \sqrt{1 + \frac{C_1}{C_0 + C_L}}$	Hz	15	1	4

Tableau 2 – Solutions pour les différentes fréquences caractéristiques

Fréquences caractéristiques	Définition	Condition	Equation constituante pour une fréquence
f_m	Fréquence de l'admittance maximale (impédance minimale)	$\frac{d Z }{d\omega} = 0$	$(\Omega^2 + \delta^2)^2 - 2\delta^2(\Omega + r) - 2\Omega r(1 - \Omega) - \Omega^2 = 0$
f_s	Fréquence de résonance (série) dynamique	$X_1 = 0$	$\Omega = 0$
f_r	Fréquence de résonance	$X_e = B_p = 0$	$\Omega(1 - \Omega) - \delta^2 = 0$
f_a	Fréquence d'antirésonance	$X_e = B_p = 0$	$\Omega(1 - \Omega) - \delta^2 = 0$
f_p	Fréquence de résonance parallèle (sans perte)	$ X_e = \infty$ pour $R_1 = 0$	$\Omega = 1$
f_n	Fréquence de l'admittance minimale (impédance maximale)	$\frac{d Z }{d\omega} = 0$	$(\Omega^2 + \delta^2)^2 - 2\delta^2(\Omega + r) - 2\Omega r(1 - \Omega) - \Omega^2 = 0$

Tableau 3 – Valeurs minimales pour le rapport Q^2/r qu'il faut attendre pour des types différents de résonateurs piézoélectriques

Type du résonateur piézoélectrique	$Q = M r$	r	Q^2/r min
Céramiques piézoélectriques	90 – 500	2 – 40	200
Cristaux piézoélectriques solubles dans l'eau	200 – 50 000	3 – 500	80
Quartz	$10^4 - 10^7$	100 – 50 000	2 000

Table 2 – Solutions for the various characteristic frequencies

Characteristic frequencies	Meaning	Condition	Constituent equation for frequency
f_m	Frequency of maximum admittance (minimum impedance)	$\frac{d Z }{d\omega} = 0$	$(\Omega^2 + \delta^2)^2 - 2\delta^2(\Omega + r) - 2\Omega r(1 - \Omega) - \Omega^2 = 0$
f_s	Motional (series) resonance frequency	$X_1 = 0$	$\Omega = 0$
f_r	Resonance frequency	$X_e = B_p = 0$	$\Omega(1 - \Omega) - \delta^2 = 0$
f_a	Antiresonance frequency	$X_e = B_p = 0$	$\Omega(1 - \Omega) - \delta^2 = 0$
f_p	Parallel resonance frequency (loss-less)	$ X_e = \infty$ for $R_1 = 0$	$\Omega = 1$
f_n	Frequency of minimum admittance (maximum impedance)	$\frac{d Z }{d\omega} = 0$	$(\Omega^2 + \delta^2)^2 - 2\delta^2(\Omega + r) - 2\Omega r(1 - \Omega) - \Omega^2 = 0$

Table 3 – Minimum values for the ratio Q^2/r to be expected for various types of piezoelectric resonators

Type of piezoelectric resonator	$Q = M r$	r	$Q^2/r \text{ min}$
Piezoelectric ceramics	90 – 500	2 – 40	200
Water-soluble piezoelectric crystals	200 – 50 000	3 – 500	80
Quartz	$10^4 - 10^7$	100 – 50 000	2 000

Tableau 4 – Relations approximatives entre les fréquences caractéristiques et la fréquence de résonance série f_s d'un résonateur piézoélectrique

Fréquence caractéristique	1 ^{ère} approximation		2 ^{ème} approximation	
	$\frac{f}{f_s}$	Ecart $\frac{\Delta f}{f_s}$ à partir d'une valeur plus précise	$\frac{f}{f_s}$	Ecart $\frac{\Delta f}{f_s}$ à partir d'une valeur plus précise
f_m	$\frac{f_m}{f_s} = 1$	$-\frac{1}{2M^2r}$	$\frac{f_m}{f_s} = \sqrt{1 + \frac{1}{2r} \left[1 - \sqrt{1 + \frac{4}{M^2}} \right]}$	$-\frac{1}{2M^4r^2}$
f_r	$\frac{f_r}{f_s} = 1$	$\frac{1}{2M^2r}$	$\frac{f_r}{f_s} = \sqrt{1 + \frac{1}{2r} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{4}{M^2}} \right]}$	$\frac{1}{2M^4r^2}$
f_a	$\frac{f_a}{f_s} = 1 + \frac{1}{2r}$	$-\frac{1}{2M^2r} \left(\frac{1}{r} + 1 \right)$	$\frac{f_a}{f_s} = \sqrt{1 + \frac{1}{2r} \left[1 + \sqrt{1 - \frac{4}{M^2}} \right]}$	$-\frac{1}{2M^2r} \times \frac{1}{r}$
f_n	$\frac{f_n}{f_s} = 1 + \frac{1}{2r}$	$\frac{1}{2M^2r} \left(\frac{1}{r} + 1 \right)$	$\frac{f_n}{f_s} = \sqrt{1 + \frac{1}{2r} \left[1 + \sqrt{1 + \frac{4}{M^2}} \right]}$	$\frac{1}{2M^2r} \times \frac{1}{r}$
f_p	$\frac{f_p}{f_s} = 1 + \frac{1}{2r}$	$-\frac{1}{8r^2}$	$\frac{f_p}{f_s} = \sqrt{1 + \frac{1}{r}}$	0

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60122-1:2002

Table 4 – Approximate relations between the characteristic frequencies and the series resonance frequency f_s of a piezoelectric resonator

Characteristic frequency	1 st approximation		2 nd approximation	
	$\frac{f}{f_s}$	Deviation $\frac{\Delta f}{f_s}$ from a more precise value	$\frac{f}{f_s}$	Deviation $\frac{\Delta f}{f_s}$ from a more precise value
f_m	$\frac{f_m}{f_s} = 1$	$-\frac{1}{2M^2r}$	$\frac{f_m}{f_s} = \sqrt{1 + \frac{1}{2r} \left[1 - \sqrt{1 + \frac{4}{M^2}} \right]}$	$\frac{1}{2M^4r^2}$
f_r	$\frac{f_r}{f_s} = 1$	$\frac{1}{2M^2r}$	$\frac{f_r}{f_s} = \sqrt{1 + \frac{1}{2r} \left[1 - \sqrt{1 + \frac{4}{M^2}} \right]}$	$\frac{1}{2M^4r^2}$
f_a	$\frac{f_a}{f_s} = 1 + \frac{1}{2r}$	$-\frac{1}{2M^2r} \left(\frac{1}{r} + 1 \right)$	$\frac{f_a}{f_s} = \sqrt{1 + \frac{1}{2r} \left[1 + \sqrt{1 + \frac{4}{M^2}} \right]}$	$-\frac{1}{2M^2r} \times \frac{1}{r}$
f_n	$\frac{f_n}{f_s} = 1 + \frac{1}{2r}$	$\frac{1}{2M^2r} \left(\frac{1}{r} + 1 \right)$	$\frac{f_n}{f_s} = \sqrt{1 + \frac{1}{2r} \left[1 + \sqrt{1 + \frac{4}{M^2}} \right]}$	$\frac{1}{2M^2r} \times \frac{1}{r}$
f_p	$\frac{f_p}{f_s} = 1 + \frac{1}{2r}$	$-\frac{1}{8r^2}$	$\frac{f_p}{f_s} = \sqrt{1 + \frac{1}{r}}$	0

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60122-1:2002

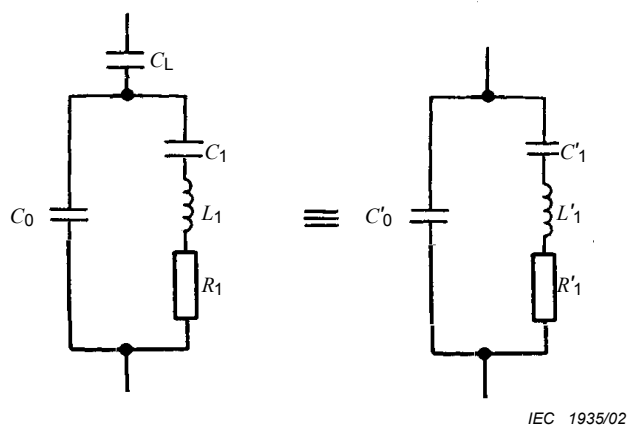


Figure 5 – Circuit électrique équivalent du résonateur piézoélectrique avec une capacité (de charge) C_L

$$\begin{aligned}
 L'_1 &= L_1 \left(1 + \frac{C_0}{C_L} \right)^2 \\
 C'_1 &= C_1 \frac{1}{\left(1 + \frac{C_0}{C_L} \right)^2 \left(1 + \frac{C_1}{C_0 + C_L} \right)} \\
 R'_1 &= R_1 \left(1 + \frac{C_0}{C_L} \right)^2 \\
 C'_0 &= \left(\frac{C_0 C_L}{C_0 + C_L} \right) \\
 f_L &= f_s \sqrt{1 + \frac{C_1}{C_0 + C_L}} \approx f_s \left(1 + \frac{C_1}{2(C_0 + C_L)} \right)
 \end{aligned}
 \tag{15}$$

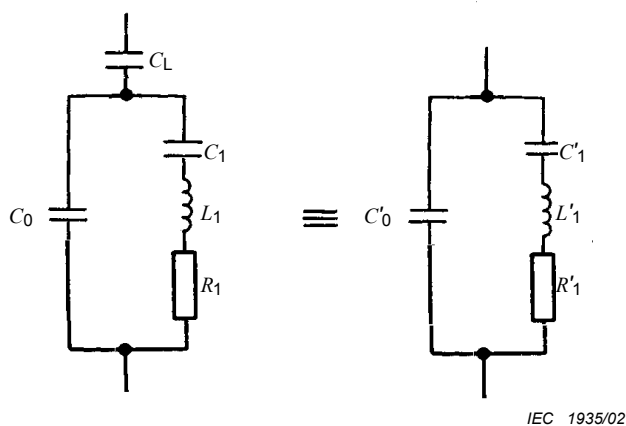


Figure 5 – Equivalent circuit of a piezoelectric resonator with a series (load) capacitance C_L

$$\begin{aligned}
 L'_1 &= L_1 \left(1 + \frac{C_0}{C_L} \right)^2 \\
 C'_1 &= C_1 \frac{1}{\left(1 + \frac{C_0}{C_L} \right)^2 \left(1 + \frac{C_1}{C_0 + C_L} \right)} \\
 R'_1 &= R_1 \left(1 + \frac{C_0}{C_L} \right)^2 \\
 C'_0 &= \left(\frac{C_0 C_L}{C_0 + C_L} \right)
 \end{aligned}
 \tag{15}$$

$$f_L = f_s \sqrt{1 + \frac{C_1}{C_0 + C_L}} \approx f_s \left(1 + \frac{C_1}{2(C_0 + C_L)} \right)$$

2.3 Valeurs et caractéristiques préférentielles

De préférence, il convient de choisir les valeurs parmi les paragraphes suivants:

2.3.1 Gammes de températures en degrés Celsius (°C) pour un fonctionnement à température ambiante

–55 à +125	–30 à +80	–10 à +60
–55 à +105	–30 à +70	–10 à +50
–55 à +100	–25 à +80	0 à +60
–55 à +90	–20 à +85	0 à +50
–40 à +90	–20 à +80	+5 à +55
–40 à +85	–20 à +70	+10 à +40
–40 à +80	–20 à +60	+15 à +50
–40 à +70	–10 à +70	

2.3.2 Gammes de températures élevées en degrés Celsius (°C) convenant pour un fonctionnement en enceinte

60 ± 5	75 ± 5
65 ± 5	80 ± 5
70 ± 5	85 ± 5

2.3.3 Tolérance de fréquence (1×10^{-6})

±200	±25	±7,5
±100	±20	±5
±50	±15	±4
±40	±10	±2,5
±30		±1

2.3.4 Conditions de fonctionnement

Capacité de charge 10 pF

Capacité de charge 15 pF

Capacité de charge 20 pF

Capacité de charge 30 pF

Capacité de charge 50 pF

Résonance série.

2.3.5 Niveaux d'excitation

Cisaillement d'épaisseur/AT:

Courant, en μA

150

200

1 000

2 000

2.3 Preferred ratings and characteristics

Values should preferably be chosen from the following paragraphs.

2.3.1 Temperature ranges in degrees Celsius (°C) suitable for ambient operation

–55 to +125	–30 to +80	–10 to +60
–55 to +105	–30 to +70	–10 to +50
–55 to +100	–25 to +80	0 to +60
–55 to +90	–20 to +85	0 to +50
–40 to +90	–20 to +80	+5 to +55
–40 to +85	–20 to +70	+10 to +40
–40 to +80	–20 to +60	+15 to +50
–40 to +70	–10 to +70	

2.3.2 Elevated temperature ranges in degrees Celsius (°C) suitable for oven control

60 ± 5	75 ± 5
65 ± 5	80 ± 5
70 ± 5	85 ± 5

2.3.3 Frequency tolerance (1×10^{-6})

±200	±25	±7,5
±100	±20	±5
±50	±15	±4
±40	±10	±2,5
±30		±1

2.3.4 Circuit conditions

10 pF load capacitance
 15 pF load capacitance
 20 pF load capacitance
 30 pF load capacitance
 50 pF load capacitance
 Series resonance.

2.3.5 Levels of drive

Thickness shear/AT:

Current, in μA

150
 200
 1 000
 2 000

Puissance, en μW

1
10
100
500

Flexion et cisaillement plan:

Courant, en μA

100
200

Extension:

Courant, en μA

500
1 000

2.3.6 Influence du niveau d'excitation

Résistance de résonance Ω	Rapport de résistance, $\frac{R_{r1}}{R_{r2}}$
< 5	2,2
5 à 10	2,0
10 à 20	1,8
20 à 35	1,5
35 à 50	1,3
>50	1,2

2.3.7 Catégorie climatique

55/105/56

Pour les besoins lorsque la gamme de températures du résonateur s'étend au-delà de $-55\text{ }^{\circ}\text{C}$ à $+105\text{ }^{\circ}\text{C}$, une catégorie climatique cohérente avec la gamme de températures de fonctionnement doit être spécifiée.

2.3.8 Sévérité des secousses

$4\,000 \pm 10$ secousses à 390 m/s^2 d'accélération crête dans chaque direction le long des trois axes perpendiculaires (voir 4.8.6).

Durée d'impulsion 6 ms.

Power, in μW

1

10

100

500

Flexure and face shear:

Current, in μA

100

200

Extensional:

Current, in μA

500

1 000

2.3.6 Drive level dependency

Resonance resistance Ω	Resistance ratio, $\frac{R_{r1}}{R_{r2}}$
< 5	2,2
5 to 10	2,0
10 to 20	1,8
20 to 35	1,5
35 to 50	1,3
>50	1,2

2.3.7 Climatic category

55/105/56

For requirements where the operating temperature range of the crystal unit is greater than $-55\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $+105\text{ }^{\circ}\text{C}$, a climatic category consistent with the operating temperature range shall be specified.

2.3.8 Bump severity

$4\,000 \pm 10$ bumps at 390 m/s^2 peak acceleration in each direction along three mutually perpendicular axes (see 4.8.6).

Pulse duration 6 ms.

2.3.9 Sévérité des vibrations

10 Hz à 55 Hz
amplitude de déplacement 0,75 mm
(valeur crête)

55 Hz à 500 Hz
ou 55 Hz à 2 000 Hz
amplitude d'accélération 98,1 m/s²
(valeur crête)

30 min dans chacun des trois axes
perpendiculaires à 1 octave/min (voir 4.8.7)

10 Hz à 55 Hz
amplitude de déplacement 1,5 mm
(valeur crête)

55 Hz à 2 000 Hz
amplitude d'accélération 196,2 m/s²
(valeur crête)

30 min dans chacun des trois axes
perpendiculaires à 1 octave/min (voir 4.8.7)

Sévérités de vibration aléatoires: à l'étude

2.3.10 Sévérité des chocs

981 m/s² d'accélération crête pour une durée de 6 ms; trois chocs dans chaque direction le long des trois axes perpendiculaires (voir 4.8.8), l'impulsion semi-sinusoïdale, sauf indication contraire dans la spécification particulière.

2.3.11 Taux de fuite

10⁻³ Pa·cm³/s (10⁻⁸ bar·cm³/s).

2.4 Marquage

2.4.1 Les informations données pour le marquage sont sélectionnées de la liste suivante; l'importance relative de chaque donnée est indiquée par sa position dans la liste:

- désignation du type comme défini dans la spécification particulière;
- fréquence nominale en kilohertz (kHz) ou mégahertz (MHz);
- année et semaine de fabrication (quatre chiffres);
- code d'identification d'usine;
- nom du fabricant ou marque commerciale;
- marque de conformité (à moins qu'un certificat de conformité ne soit utilisé).

2.4.2 Le résonateur à quartz doit être clairement marqué des données figurant en a), b) et c) ci-dessus, et du plus grand nombre possible d'autres données, si cela est considéré comme nécessaire. Il convient que toute duplication d'information dans le marquage du résonateur soit évitée.

Lorsque la surface disponible des enveloppes de résonateurs miniatures impose des limites quant à la zone de marquage, les instructions pour le marquage doivent être données dans la spécification particulière.

2.4.3 L'emballage primaire contenant le ou les résonateurs doit être clairement marqué avec toutes les informations répertoriées en 2.4.1.

2.4.4 Tout marquage complémentaire doit être appliqué en évitant toute possibilité de confusion.

2.3.9 Vibration severity

10 Hz to 55 Hz 0,75 mm displacement amplitude (peak value)	30 min in each of three mutually perpendicular axes at 1 octave/min (see 4.8.7)
55 Hz to 500 Hz or 55 Hz to 2 000 Hz 98,1 m/s ² acceleration amplitude (peak value)	
10 Hz to 55 Hz 1,5 mm displacement amplitude (peak value)	30 min in each of three mutually perpendicular axes at 1 octave/min (see 4.8.7)
55 Hz to 2 000 Hz 196,2 m/s ² acceleration amplitude (peak value)	

Random vibration severities: under consideration

2.3.10 Shock severity

981 m/s² peak acceleration for 6 ms duration; three shocks in each direction along three mutually perpendicular axes (see 4.8.8), half sine pulse, unless otherwise stated in the detail specification.

2.3.11 Leak rate

10⁻³ Pa·cm³/s (10⁻⁸ bar·cm³/s).

2.4 Marking

2.4.1 The information given in the marking is selected from the following list: the relative importance of each item is indicated by its position in the list:

- type designation as defined in the detail specification;
- nominal frequency in kilohertz (kHz) or megahertz (MHz);
- year and week (four digits) of manufacture;
- factory identification code;
- manufacturer's name or trade mark;
- mark of conformity (unless a certificate of conformity is used).

2.4.2 The crystal units shall be clearly marked with a), b) and c) above and with as many as possible of the remaining items as is considered necessary. Any duplication of information in the marking on the crystal unit should be avoided.

Where the available surface area of miniature crystal enclosures imposes practical limits on the amount of marking, instructions on the marking to be applied shall be given in the detail specification.

2.4.3 The primary package containing the crystal unit(s) shall be clearly marked with all the information listed in 2.4.1.

2.4.4 Any additional marking shall be so applied that no confusion can arise.

3 Procédures d'assurance de la qualité

Il existe deux méthodes pour l'assurance de la qualité des résonateurs à quartz: l'homologation et l'agrément de savoir-faire.

3.1 Etape initiale de fabrication

Selon 3.1.1.2 de la CEI QC 001002-3, l'étape initiale de fabrication est la finition de surface de la lame de quartz.

NOTE La finition de surface de la lame de quartz peut être l'une des opérations suivantes: rodage, polissage, gravure, nettoyage, dans le cas des lames polies.

3.2 Modèles associables

L'association des modèles en vue de l'homologation, de l'agrément de savoir-faire et du contrôle de conformité de la qualité doit être prescrite dans la spécification intermédiaire concernée.

3.3 Sous-traitance

Les procédures doivent être en conformité avec 3.1.2 de la CEI QC 001002-3.

Cependant, la finition de surface de la lame de quartz et tous les processus de fabrication qui suivent doivent être effectués par le fabricant auquel l'agrément a été accordé.

3.4 Agrément du fabricant

Pour obtenir cet agrément, le fabricant doit satisfaire aux exigences de l'article 2 de la CEI 001002-3.

3.5 Procédures d'agrément

3.5.1 Généralités

Pour l'assurance de qualité des résonateurs à quartz, on peut utiliser soit l'agrément de savoir-faire, soit l'homologation. Ces procédures doivent être conformes à celles stipulées dans la CEI QC 001001 et la CEI QC 001002-3.

3.5.2 Agrément de savoir-faire

L'agrément de savoir-faire est approprié lorsque des résonateurs à quartz associables basés sur des règles de conception communes sont fabriqués selon un groupe de procédés de fabrication communs.

Dans le cadre de l'agrément de savoir-faire, trois catégories de spécifications particulières peuvent être mises en oeuvre.

a) Pour les composants pour agrément de savoir-faire (CQC)

La spécification particulière doit être établie pour chacun des composants avec l'accord de l'Organisme National de Surveillance (l'ONS). Elle doit identifier le but du CQC et inclure tous les niveaux de contraintes et limites d'essai le concernant.

b) Pour les produits sur catalogue

Quand un composant couvert par l'agrément de savoir-faire est destiné à être proposé en tant que produit sur catalogue, une spécification particulière doit être écrite en conformité avec la spécification particulière cadre. De telles spécifications doivent être enregistrées par l'IECQ et le composant peut être introduit dans la CEI QC 001005.

3 Quality assessment procedures

Two methods are available for the approval of quartz crystal units of assessed quality. They are qualification approval and capability approval.

3.1 Primary stage of manufacture

In accordance with 3.1.1.2 of IEC QC 001002-3, the primary stage of manufacture is the final surface finishing of the crystal element.

NOTE The final surface finishing of the crystal element could be any of the following operations: lapping; polishing; etching; cleaning, in the case of polished plates.

3.2 Structurally similar components

The grouping of structurally similar components for the purpose of qualifications approval, capability approval and quality conformance inspection shall be prescribed in the relevant sectional specification.

3.3 Subcontracting

These procedures shall be in accordance with 3.1.2 of IEC QC 001002-3.

However, the final surface finishing of the crystal elements and all subsequent processes shall be carried out by the manufacturer to whom approval has been granted.

3.4 Manufacturer's approval

To obtain manufacturer's approval the manufacturer shall meet the requirements of clause 2 of IEC QC 001002-3.

3.5 Approval procedures

3.5.1 General

To qualify a quartz crystal unit, either capability approval or qualification approval procedures may be used. These procedures shall conform to those stated in IEC QC 001001 and IEC QC 001002-3.

3.5.2 Capability approval

Capability approval is appropriate when structurally similar quartz crystal units based on common design rules, are fabricated, by a group of common processes.

Under capability approval detail specifications fall into the following three categories.

a) Capability qualifying components (CQCs)

A detail specification shall be prepared for each CQC as agreed with the National Supervising Inspectorate (NSI). It shall identify the purpose of the CQC and include all relevant stress levels and test limits.

b) Standard catalogue items

When a component covered by the capability approval procedure is intended to be offered as a standard catalogue item, a detail specification complying with the blank detail specification shall be written. Such specifications shall be registered by the IECQ and the component may be listed in IEC QC 001005.

c) Pour les résonateurs à quartz fabriqués à la demande

Le contenu de la spécification particulière doit être établi par accord entre le fabricant et le client selon 4.3.3 de la CEI QC 001002-3.

On trouvera des informations complémentaires sur les spécifications particulières dans la spécification intermédiaire CEI 61178-2.

Le produit et les composants pour agrément de savoir-faire (CQC) doivent subir les essais en combinaison et selon l'agrément accordé à une entreprise sur la base des règles de conception validées, des processus de fabrication et procédures de contrôle de la qualité, comme prescrits en 3.6 et dans la spécification intermédiaire CEI 61178-2.

3.5.3 Homologation

L'homologation est appropriée pour les composants fabriqués selon une conception normalisée et un processus de fabrication établi, conformément à une spécification particulière publiée.

Le programme d'essais défini dans la spécification particulière pour un niveau de sévérité et une assurance de qualité appropriée s'applique directement au résonateur à homologuer comme prescrit en 3.7 et dans la spécification intermédiaire CEI 61178-3.

3.6 Procédures pour l'agrément de savoir-faire

3.6.1 Généralités

Les procédures pour l'agrément de savoir-faire doivent être conformes à la CEI QC 001002-3.

3.6.2 Aptitude à l'agrément de savoir-faire

Le fabricant doit satisfaire aux exigences de 4.2.1 de la CEI QC 001002-3 et à celles liées à l'étape initiale de fabrication définie en 3.1 de cette spécification générique.

3.6.3 Demande d'agrément de savoir-faire

Pour obtenir l'agrément de savoir-faire le fabricant doit appliquer les règles de procédures définies dans l'article 4 de la CEI QC 001002-3.

3.6.4 Obtention de l'agrément de savoir-faire

L'agrément de savoir-faire doit être accordé à un fabricant lorsque les procédures en conformité avec l'article 4 de la CEI QC 001002-3 ont été effectuées avec succès.

3.6.5 Manuel de savoir-faire

Le contenu du manuel de savoir-faire doit être établi en conformité avec les exigences de la spécification intermédiaire. Le manuel de savoir-faire est un document confidentiel et doit être traité comme tel par l'ONS. Le fabricant peut, s'il le désire, en divulguer tout ou partie à une tierce personne.

3.7 Procédures pour l'homologation

3.7.1 Généralités

Les procédures pour l'homologation doivent être conformes à l'article 3 de la CEI QC 001002-3.

3.7.2 Aptitude à l'agrément du fabricant

Le fabricant doit satisfaire aux exigences de 3.1.1 de la CEI QC 001002-3 et à celles liées à l'étape initiale de fabrication définie en 3.1 de cette spécification générique.

c) Custom built quartz crystal units

The content of the detail specification shall be determined by agreement between the manufacturer and the customer in accordance with 4.3.3 of IEC QC 001002-3.

Further information on detail specifications is contained in the sectional specification IEC 61178-2.

The product and capability qualifying components (CQCs) are tested in combination and approval given to a manufacturing facility on the basis of validated design rules, processes and quality control procedures. Further information is given in 3.6 and in the sectional specification IEC 61178-2.

3.5.3 Qualification approval

Qualification approval is appropriate for components manufactured to a standard design and established production process and conforming to a published detail specification.

The programme of tests defined in the detail specification for the appropriate assessment and severity level applies directly to the quartz crystal unit to be qualified, as prescribed in 3.7 and the sectional specification IEC 61178-3.

3.6 Procedures for capability approval

3.6.1 General

The procedures for capability approval shall be in accordance with IEC QC 001002-3.

3.6.2 Eligibility for capability approval

The manufacturer shall comply with the requirement of 4.2.1 of IEC QC 001002-3 and the primary stage of manufacture as defined in 3.1 of this generic specification.

3.6.3 Application for capability approval

In order to obtain capability approval the manufacturer shall apply the rules of procedure given in clause 4 of IEC QC 001002-3.

3.6.4 Granting of capability approval

Capability approval shall be granted when the procedures in accordance with 4 of IEC QC 001002-3 have been successfully completed.

3.6.5 Capability manual

The contents of the capability manual shall be in accordance with the requirements of the sectional specification. The NSI shall treat the capability manual as a confidential document. The manufacturer may, if he so wishes, disclose part or all of it to a third party.

3.7 Procedures for qualification approval

3.7.1 General

The procedures for qualification approval shall be in accordance with clause 3 of IEC QC 001002-3.

3.7.2 Eligibility for qualification approval

The manufacturer shall comply with the requirements of 3.1.1 of IEC QC 001002-3 and the primary stage of manufacture as defined in 3.1 of this generic specification.

3.7.3 Demande d'homologation

Pour obtenir l'homologation le fabricant doit appliquer les règles de procédures définies en 3.1.3 de la CEI QC 001002-3.

3.7.4 Obtention de l'homologation

L'homologation doit être accordée lorsque les procédures en conformité avec 3.1.5 de la CEI QC 001002-3 ont été effectuées avec succès.

3.7.5 Contrôle de conformité de la qualité

Les files d'essai pour le contrôle de conformité de la qualité doivent être prescrites dans la spécification particulière cadre associée à la spécification intermédiaire.

3.8 Méthodes d'essai

Les méthodes d'essai à utiliser doivent être choisies dans la spécification générique. Au cas où un essai prescrit ne s'y trouverait pas, il est nécessaire de le définir dans la spécification particulière.

3.9 Exigences de sélection

Quand la sélection par le client est requise, cela doit être spécifié dans la spécification particulière.

3.10 Travaux de retouche et de réparation

3.10.1 Retouche

La retouche est la correction d'un défaut ou d'une erreur dans le processus de fabrication; elle ne doit pas être effectuée si la spécification intermédiaire l'interdit. La spécification intermédiaire doit indiquer s'il y a une restriction quant au nombre de fois où une retouche peut être effectuée sur un composant spécifique.

Toute retouche doit être effectuée avant la formation du lot de contrôle présenté pour l'exécution des contrôles prescrits dans la spécification particulière.

Les procédures de retouche doivent être entièrement décrites dans les documents concernés du fabricant et doivent être effectuées sous la responsabilité directe du contrôleur. La sous-traitance des retouches n'est pas autorisée.

3.10.2 Réparation

La réparation est la correction d'un défaut décelé sur un composant après livraison au client.

Les composants qui ont été réparés ne peuvent plus être considérés comme étant représentatifs de la production du fabricant et sont exclus de système IECQ.

3.11 Rapports certifiés de lots acceptés

Les exigences de l'article 1.5 de la CEI QC 001002-2 s'appliquent. Lorsque les rapports certifiés de lots acceptés (RCLA) sont exigés dans la spécification intermédiaire pour l'homologation et sont demandés par le client, les résultats des essais spécifiés doivent être condensés.

3.12 Validité de livraison

Les résonateurs à quartz conservés au-delà de deux ans après avoir été acceptés doivent subir à nouveau les essais électriques détaillés en 4.7.1 et 4.7.3 et inclure un échantillon essayé comme indiqué au point a) de 4.8.3 avant de pouvoir être livrés.

3.7.3 Application for qualification approval

In order to obtain qualification approval the manufacturer shall apply the procedures given in 3.1.3 of IEC QC 001002-3.

3.7.4 Granting of qualification approval

Qualification approval shall be granted when the procedures in accordance with 3.1.5 of IEC QC 001002-3 have been successfully completed.

3.7.5 Quality conformance inspection

The blank detail specification associated with the sectional specification shall prescribe the test schedule for quality conformance inspection.

3.8 Test procedures

The test procedures to be used shall be selected from this generic specification. If any required test is not included, then it shall be defined in the detail specification.

3.9 Screening requirements

Where screening is required by the customer for quartz crystal units this shall be specified in the detail specification.

3.10 Rework and repair work

3.10.1 Rework

Rework is the rectification of processing errors and shall not be carried out if prohibited by the sectional specification. The sectional specification shall state if there is a restriction on the number of occasions that rework may take place on a specific component.

All rework shall be carried out prior to the formation of the inspection lot offered for inspection to the requirements of the detail specification.

Such rework procedures shall be fully described in the relevant documentation produced by the manufacturer and shall be carried out under the direct control of the chief inspector. Sub-contracting of rework is not permitted.

3.10.2 Repair work

Repair work is the correction of defects in a component after release to the customer.

Components that have been repaired can no longer be considered as representative of the manufacturer's production and may not be released under the IECQ System.

3.11 Certified records of released lots

The requirements of clause 1.5 of IEC QC 001002-2 shall apply. When certified records of released lots (CRRL) are prescribed in the sectional specification for qualification approval and are requested by the customer, the results of the specified tests shall be summarized.

3.12 Validity of release

Crystal units held for a period exceeding two years following acceptance inspection shall be reinspected for the electrical tests detailed in 4.7.1 and 4.7.3, with a sample tested as described in item a) of 4.8.3, prior to release.

3.13 Acceptation pour livraison

Les résonateurs à quartz doivent être acceptés pour livraison en conformité avec 3.2.6 et 4.3.2 de la CEI QC 001002-3.

3.14 Paramètres non destinés au contrôle

Seuls les paramètres d'un composant, spécifiés dans la spécification particulière et qui ont été vérifiés, peuvent être considérés comme étant dans les limites spécifiées. On ne peut assurer qu'un paramètre non spécifié restera inchangé d'un composant à un autre. S'il apparaît nécessaire, pour une raison quelconque, qu'un paramètre supplémentaire soit vérifié, il convient qu'une nouvelle spécification, élargie, soit utilisée. Les méthodes d'essai complémentaires doivent être entièrement décrites et les limites appropriées, le NQA et le niveau de contrôle spécifiés.

4 Procédures d'essai et de mesure

4.1 Généralités

Les procédures d'essai et de mesure doivent être effectuées en conformité avec la spécification particulière applicable.

4.2 Autres méthodes d'essai

Les mesures doivent être de préférence réalisées suivant les méthodes spécifiées. Toute autre méthode, donnant des résultats équivalents, peut être utilisée, sauf en cas de désaccord.

NOTE «Equivalent» signifie que la valeur de la caractéristique obtenue par une telle méthode correspond, aux tolérances spécifiées près, à celle obtenue par la méthode spécifiée.

4.3 Précision de mesure

Les limites données dans la spécification particulière sont les valeurs vraies. Les incertitudes de mesure doivent être prises en compte pour l'examen des résultats. Des précautions sont prises pour réduire au minimum les erreurs de mesure.

4.4 Conditions normales d'essai

Sauf indication contraire, tous les essais doivent être effectués sous conditions atmosphériques normales, comme spécifié en 5.3 de la CEI 60068-1.

Température	15 °C à 35 °C
Humidité relative	45 % à 75 %
Pression atmosphérique	86 kPa à 106 kPa (860 mbar à 1 060 mbar)

En cas de litige, les conditions de référence sont:

Température	25 °C ± 1 °C
Humidité relative	48 % à 52 %
Pression atmosphérique	86 kPa à 106 kPa (860 mbar à 1 060 mbar)

Avant d'effectuer les mesures, les résonateurs à quartz doivent être stockés à la température de mesure pendant le temps suffisant pour que le résonateur à quartz ait atteint cette température.

3.13 Release for delivery

Quartz crystal units shall be released in accordance with 3.2.6 and 4.3.2 of IEC QC 001002-3.

3.14 Unchecked parameters

Only those parameters of a component which have been specified in a detail specification and which were subject to testing can be assumed to be within the specified limits. It should not be assumed that any parameter not specified will remain unchanged from one component to another. Should it be necessary for further parameters to be controlled, then a new, more extensive, detail specification should be used. Any additional test method(s) shall be fully described and appropriate limits, AQLs and inspection levels specified.

4 Test and measurement procedures

4.1 General

The test and measurement procedures shall be carried out in accordance with the relevant detail specification.

4.2 Alternative test methods

Measurements shall preferably be carried out using the methods specified. Any other method giving equivalent results may be used except in case of dispute.

NOTE By “equivalent” it is meant that the value of the characteristic established by such other method falls within the specified limits when measured by the specified method.

4.3 Precision of measurement

The limits given in detail specifications are true values. Measurement inaccuracies shall be taken into account when evaluating the results. Precautions should be taken to reduce measurement errors to a minimum.

4.4 Standard conditions for testing

Unless otherwise specified, all tests shall be carried out under the standards atmospheric conditions for testing as specified in 5.3 of IEC 60068-1.

Temperature	15 °C to 35 °C
Relative humidity	45 % to 75 %
Air pressure	86 kPa to 106 kPa (860 mbar to 1 060 mbar)

In case of dispute, the referee conditions are:

Temperature	25 °C ± 1 °C
Relative humidity	48 % to 52 %
Air pressure	86 kPa to 106 kPa (860 mbar to 1 060 mbar)

Before measurements are made, the crystal units shall be stored at the measuring temperature for a time sufficient to allow the crystal resonator to reach this temperature.

Les conditions de reprise et les conditions normales pour le séchage sont données en 5.4 de la CEI 60068-1.

La température ambiante relevée pendant les mesures doit être enregistrée et consignée dans le rapport d'essai.

4.5 Inspection visuelle

Sauf spécification contraire, l'inspection visuelle externe doit être faite dans les conditions normales d'éclairage et de vision du laboratoire.

4.5.1 Inspection visuelle, essai A

Le résonateur doit être examiné à l'oeil nu, pour vérifier que sa fabrication et sa finition sont satisfaisantes. Le marquage doit être lisible.

4.5.2 Inspection visuelle, essai B

Le résonateur doit être examiné sous un appareil d'optique de grossissement 10. On ne doit pas constater de fêlure dans le verre, ni de dégradation sur les sorties. Une écaille sur le bord d'un ménisque n'est pas considérée comme une fêlure.

4.5.3 Inspection visuelle, essai C

Le résonateur doit être examiné à l'oeil nu; on ne doit pas observer de trace de corrosion, ou d'autre défaut préjudiciable à un emploi satisfaisant. Le marquage doit être lisible.

4.6 Inspection dimensionnelle et de mesure

4.6.1 Dimensions, essai A

Les dimensions, l'espacement, et l'alignement des sorties doivent être contrôlés, en utilisant, si possible, les calibres spécifiés. Les dimensions, l'espacement et l'alignement doivent être conformes aux valeurs spécifiées.

4.6.2 Dimensions, essai B

Les dimensions doivent être mesurées et conformes aux valeurs spécifiées. Les dimensions sont spécifiées dans la CEI 60122-3 ainsi que la procédure de mesurage applicable ou suivant indication dans la spécification particulière.

4.7 Procédures d'essais électriques

4.7.1 Fréquence et résistance de résonance

Sauf indication contraire dans la spécification particulière, les mesures doivent être faites à $25\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ pour les résonateurs à température non contrôlée ou au point milieu de la gamme de températures, à $\pm 1\text{ °C}$ près, pour les résonateurs à température contrôlée.

La fréquence et la résistance de résonance du résonateur doivent être mesurées suivant les conditions indiquées dans la spécification particulière, et doivent se situer dans les limites spécifiées.

NOTE Les méthodes de mesure préférentielles sont décrites dans la CEI 60444-1, la CEI 60444-2, la CEI 60444-4 et la CEI 60444-5 selon la fréquence du résonateur à quartz à mesurer. Toute autre méthode de mesure peut être utilisée, à condition de prouver que les résultats obtenus se corréleront avec ceux obtenus par l'une des méthodes préférentielles.

4.7.2 Influence du niveau d'excitation

Il est important, lorsqu'un essai d'influence du niveau d'excitation est spécifié, que celui-ci soit effectué au moins cinq jours après le dernier essai électrique sur le résonateur à quartz (voir la CEI 60444-6).

Controlled recovery conditions and standard conditions for assisted drying are given in 5.4 of IEC 60068-1.

The ambient temperature during the measurements shall be recorded and stated in the test report.

4.5 Visual inspection

Unless otherwise specified, external visual examination shall be performed under normal factory lighting and visual conditions.

4.5.1 Visual test A

The crystal unit shall be visually examined to ensure that the condition, workmanship and finish are satisfactory. The marking shall be legible.

4.5.2 Visual test B

The crystal unit shall be visually examined under $\times 10$ magnification. There shall be no cracks in the glass or damage to the terminations. Minute flaking around the feather edge of a meniscus shall not be considered a crack.

4.5.3 Visual test C

The crystal unit shall be visually examined. There shall be no corrosion or other deterioration likely to impair satisfactory operation. The marking shall be legible.

4.6 Dimensioning and gauging procedures

4.6.1 Dimensions, test A

The dimensions, spacing and alignment of the terminations shall be checked, where appropriate using the gauges specified. The dimensions, spacing and alignment shall comply with the specified values.

4.6.2 Dimensions, test B

The dimensions shall be measured and they shall comply with the specified values. Dimensions are specified in IEC 60122-3 together with the gauging procedure as appropriate or as specified in the detail specification.

4.7 Electrical test procedures

4.7.1 Frequency and resonance resistance

Unless otherwise defined in the detail specification, the measurements shall be carried out at $25\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ for non-temperature controlled crystal units; or at the mid-point of the temperature range $\pm 1\text{ °C}$ for temperature controlled units.

The frequency and resonance resistance of the crystal unit shall be measured under the conditions stated in the detail specification and be within the specified limits.

NOTE Preferred methods of measurement are described in IEC 60444-1, IEC 60444-2, IEC 60444-4 and IEC 60444-5 depending on the frequency of the crystal unit under test. Any other measurement method may be used provided results correlate with those obtained using preferred values.

4.7.2 Drive level dependency

It is important that when a drive level dependency test is specified, this test shall be carried out at least five days after any previous activation of the crystal unit (see IEC 60444-6).

Les mesures spécifiées en 4.7.1 doivent être effectuées à deux niveaux d'excitation donnés. Celles-ci sont normalement à un niveau bas d'excitation, suivi d'un niveau haut. Sauf indication contraire, le niveau bas ne doit pas être supérieur à 50 μA et le niveau haut ne doit pas être inférieur à 1 000 μA . Le changement de la résistance de résonance ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans la spécification particulière.

4.7.3 Fréquence et résistance de résonance en fonction de la température

NOTE Les essais A et B peuvent être associés, à condition que l'essai A s'effectue en température variable, continue et commence à la plus basse des deux températures: température minimale de la gamme de températures de fonctionnement, ou $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ (en choisissant la température la plus basse d'entre elles).

Le niveau d'excitation et la capacité de charge doivent être relevés comme indiqué dans la spécification particulière, à la température de référence. On ne doit pas effectuer de réglage sur le banc de mesure pendant les essais.

Essai A

A partir d'une température extrême de la gamme de températures de fonctionnement, la fréquence et les résistances de résonance du résonateur à quartz (voir 4.7.1) doivent être mesurées dans toute la gamme de températures de fonctionnement, au moins tous les $1,5\text{ }^{\circ}\text{C}$, en s'assurant que le résonateur à quartz est à l'équilibre thermique à chaque mesure.

Le résonateur peut être mesuré en température variable, à condition que la vitesse de changement de la température soit telle que les mesures obtenues suivant cette méthode et celles des paliers stabilisés soient corrélées.

Le résonateur doit être dans les limites spécifiées pendant cet essai.

Essai B

La température de l'enveloppe du résonateur à quartz doit être élevée de $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ à $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$ pendant au plus 1 min. Pendant cet essai, la fréquence et la résistance de résonance (voir 4.7.1) doivent être mesurées de $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ou moins à $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$ pour assurer les lectures continues. Il ne doit pas se produire de variations discontinues de la fréquence et/ou de la résistance. Une discontinuité de la fréquence et/ou de la résistance met en évidence la présence d'humidité dans l'enveloppe.

NOTE La présence d'humidité ne peut être vérifiée que par un changement positif de la température.

4.7.4 Réponses indésirables

La fréquence doit être balayée suivant la gamme définie dans la spécification particulière, et on vérifie la résistance du résonateur au niveau d'excitation défini par la spécification particulière pour la réponse principale.

Le rapport entre la résistance de résonance de toute réponse indésirable et la résistance à la fréquence de résonance désirée ne doit pas être inférieur à la valeur spécifiée dans la spécification particulière. Ou bien, la résistance de résonance des réponses indésirables doit être supérieure à celle spécifiée dans la spécification particulière.

4.7.5 Capacité parallèle

La capacité parallèle C_0 (voir figure 1) doit être mesurée à une fréquence inférieure à la fréquence de résonance du composant, à laquelle il n'y a pas de réponse d'oscillation. L'enveloppe, si elle est métallique, doit être reliée à la masse, sauf indication contraire dans la spécification particulière.

NOTE 1 Il n'y a pas de méthode directe pour mesurer avec précision C_0 . Cependant, pratiquement présente dans tous les cas, il convient de considérer C_0 comme étant la moyenne des deux valeurs de capacité parallèle obtenues à deux fréquences équidistantes, en dessus et en dessous de la fréquence de résonance f_r et suffisamment éloignées de f_r pour que l'impédance soit indépendante de toute réponse.

Measurements specified in 4.7.1 shall be carried out at two specified drive levels. These are normally at a specified low level of drive followed by a high level of drive. Unless otherwise specified, the low level shall be not more than 50 μA and the upper level not less than 1 000 μA . The change of resonance resistance shall not exceed the limit specified in the detail specification.

4.7.3 Frequency and resonance resistance as a function of temperature

NOTE Tests A and B may be combined only if test A is performed with continuously varying temperature, and is started at the lower extreme of the operating temperature range or $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$, whichever is the lower.

The level of drive and load capacitance shall be set at the levels stated in the detail specification, at the reference temperature. No subsequent adjustment shall be made to the test equipment during the tests.

Test A

Starting with the crystal unit at an extreme of the operating temperature range, the frequency and resonance resistance (see 4.7.1) shall be measured over the specified temperature range at discrete temperature intervals of not greater than $1,5\text{ }^{\circ}\text{C}$, allowing the crystal unit to reach thermal equilibrium at each temperature.

The crystal unit may be measured under conditions of continuously varying temperature, provided that tests have shown that with the chosen rate of change of temperature, the results obtained will correlate adequately with those from a stepped variation of temperature.

The crystal unit shall be within the specified limits during this test.

Test B

The temperature of the crystal enclosure shall be raised from $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$ in a period not exceeding 1 min. During this test, the frequency and the resonance resistance (see 4.7.1) shall be measured from $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$, or below, to $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$, so as to provide continuous readings. There shall be no discontinuous variation in frequency and/or resistance. Such discontinuity indicates the presence of moisture within the enclosure.

NOTE The presence of moisture can be verified only by a positive temperature change.

4.7.4 Unwanted responses

The frequency shall be scanned over the range stated in the detail specification while monitoring the resistance of the crystal unit at the drive level stated in the detail specification for the main response.

The ratio of the resonance resistance of any unwanted response to that of the response at the desired resonance frequency shall be not less than the value stated in the detail specification. Alternatively, the resonance resistance of unwanted responses shall be greater than the value stated in the detail specification.

4.7.5 Shunt capacitance

The shunt capacitance C_0 (see figure 1) shall be measured at a frequency below the fundamental resonance frequency of the unit, at which the unit shows no oscillation response. The enclosure (if metal) shall be earthed, unless otherwise stated in the detail specification.

NOTE 1 There is no direct method for measuring C_0 precisely. However, in nearly all practical cases, it is adequate to regard C_0 as the mean of two shunt capacitance values obtained at two frequencies equidistant above and below the resonance frequency f_r and sufficiently removed from f_r for the impedance to be independent of any response.